

Программа

Понедельник, 7 октября

09:00–11:00	АУ • Регистрация		
11:00–11:30	Зал АУ • Открытие		
11:30–13:00	Зал АУ • Пленарная сессия – I		
13:00–14:30	Обед		
Зал АУ		Зал ФТИ	
14:30–16:00	Объемные полупроводники – I	14:30–16:00	Двумерные полупроводниковые системы – I
16:00–16:30	Кофе		
Зал АУ		Зал ФТИ	
16:30–18:00	Поверхность, пленки, слои, наноструктуры – I	16:30–18:00	Полупроводниковые лазеры
18:00–19:30	Стендовая сессия – I (секции 1, 8, 10, 11, 12)		
20:00–22:00	Приветственный фуршет		

Вторник, 8 октября

08:30–9:15	АУ • Регистрация		
Зал АУ		Зал ФТИ	
09:15–11:00	Полупроводниковые оптические приборы	09:15–11:00	Фотоника и плазмоника
11:00–11:30	Кофе		
Зал АУ		Зал ФТИ	
11:30–13:00	Двумерные электронные системы - I	11:30–12:45	Нанопотоника – I
13:00–14:30	Обед		
Зал АУ		Зал ФТИ	
14:30–16:00	Нульмерные полупроводниковые системы – I	14:30–16:00	Полупроводниковая спинтроника – I
16:00–16:30	Кофе		
Зал АУ		Зал ФТИ	
16:30–18:00	Нульмерные полупроводниковые системы – II	16:30–18:00	Объемные полупроводники – II
18:00–19:30	Стендовая сессия – II (секции 2, 4, 6, 7)		

Среда, 9 октября

08:30–09:00	АУ • Регистрация		
Зал АУ		Зал ФТИ	
09:00–10:45	Полупроводниковые приборы	09:00–10:45	Двумерные полупроводниковые системы – II
10:45–11:15	Кофе		
Зал АУ		Зал ФТИ	
11:15–13:00	Топологические изоляторы	11:15–13:00	Полупроводниковая спинтроника – II
13:00–14:30	Обед		
15:00–19:00	Экскурсии		

Четверг, 10 октября

09:15–11:00	АУ • Регистрация		
Зал АУ		Зал ФТИ	
09:15–11:00	Нанопотоника – II	09:15–11:00	Экстремально-двумерные полупроводники
11:00–11:30	Кофе		
Зал АУ		Зал ФТИ	
11:30–13:00	Поверхностные процессы в полупроводниках	11:30–13:00	Двумерные полупроводники
13:00–14:30	Обед		
Зал АУ		Зал ФТИ	
14:30–16:00	Примеси и дефекты – I	14:30–16:00	Двумерные электронные системы – II
16:00–16:30	Кофе		
Зал АУ		Зал ФТИ	
16:30–17:30	Примеси и дефекты – II	16:30–17:30	Поверхность, пленки, слои, наноструктуры – II
17:30–19:00	Стендовая сессия – III (секции 3, 5, 9)		
20:00–23:00	Товарищеский ужин		

Пятница, 11 октября

Зал АУ		Зал ФТИ	
09:15–11:00	Полупроводниковые гетероструктуры	09:15–10:45	Объемные полупроводники – III
11:00–11:30	Кофе		
11:30–12:15	Зал АУ • Наномеханика		
12:15–13:00	Зал АУ • Пленарная сессия – II		
13:00–14:00	Зал АУ • Закрытие		

Понедельник, 7 октября

Открытие Зал АУ • 11:00–11:30

Пленарная сессия – I

Зал АУ • 11:30–13:00

- 11:30–12:15 **Родина А.В.**
Полупроводниковые нанокристаллы и квантовые точки: от открытия до наших дней
- 12:15–13:00 **Lagoudakis P.**
Computing with Quantum Fluids of Light

Объемные полупроводники – I

Зал АУ • 14:30–16:00

- 14:30–15:00 Кропотов Г.И., Рогалин В.Е., **Каплунов И.А.**
Монокристаллы германия для фотоники
- 15:00–15:15 **Двуреченский А.В.**, Якимов А.И., Зиновьева А.Ф., Зиновьев В.А., Кириенко В.В., Блошкин А.А.
Управление функциональными характеристиками компонент нанофотоники и наноэлектроники на основе кремния, сопряженных с метаматериалами
- 15:15–15:30 **Кочерешко В.П.**, Котова Л.В.
Особенности поляризованной люминесценции неоднородного ансамбля локализованных экситонов
- 15:30–15:45 **Винниченко М.Я.**, Шалыгин В.А., Махов И.С., Хвостиков В.П., Фирсов Д.А.
Индукцированная электрическим полем поляризационная анизотропия межзонной фотолюминесценции в GaAs
- 15:45–16:00 Екимов Е.А., **Усманов И.И.**, Николаев С.Н., Кондрин М.В., Кривобок В.С.
Исследование прямого края фундаментального поглощения объёмного кристалла EuS₂ по спектрам горячей фотолюминесценции и микроотражения

Двумерные полупроводниковые системы – I

Зал ФТИ • 14:30–16:00

- 14:30–15:00 **Щепетильников А.В.**, Андреева С.А., Николаев Г.А., Хисамеева А.Р., Кукушкин И.В.
Псевдоспиновый ферромагнетизм в режиме квантового эффекта Холла
- 15:00–15:15 **Бережной П.С.**, Ваньков А.Б., Кореев А.С., Кукушкин И.В.
Прямое зондирование корреляционной энергии на $\nu = 1/3$ через измерение энергии спин-зарядового возбуждения
- 15:15–15:30 **Квон З.Д.**, Курмачев Д.А., Худайбердиев Д.А., Михайлов Н.Н.
Особенности мезоскопических флуктуаций кондактанса двумерного полуметалла в HgTe квантовой яме
- 15:30–15:45 **Дикман С.М.**
Состояния квантово-холловской системы с фактором заполнения $\nu=2$ при большом значении параметра Вигнера-Зейтца ($r_s \sim 10$)
- 15:45–16:00 **Дричко И.Л.**, Смирнов И.Ю., Шахов М.А., Сафончик М.О., Бакаров А.К., Быков А.А.
Магнетофононные резонансы в структурах с квантовой ямой GaAs и барьерами из сверхрешеток AlAs/GaAs δ -Si

Поверхность, пленки, слои, наноструктуры – I

Зал АУ • 16:30–18:00

- 16:30–17:00 **Пудонин Ф.А.**, Шерстнев И.А., Косцов Д.С., Носкова Д.Д., Масракова Н.К., Болтаев А.П.
Получение наноструктур с заданной хиральностью на основе металлов и полупроводников
- 17:00–17:15 **Берковиц В.Л.**, Кособукин В.А., Улин В.П., Алексеев П.А., Солдатенков Ф.Ю., Хахулин С.А.
Анизотропные нанокластеры Au на поверхности полупроводников A^{III}B^V: физические основы и плазмоника

- 17:15–17:30 Гагис Г.С., Васильев В.И., **Чистяков Д.В.**, Бер Б.Я, Казанцев Д.Ю., Токарев В.М., Дюделев В.В., Соколовский Г.С., Кучинский В.И.
Электrolюминесценция в структурах, сформированных методом твердофазного замещения в InSb
- 17:30–17:45 **Казанцев Д.В.**
Сканирующая безапертурная микроскопия ближнего оптического поля (ASNOM) – инструмент исследования полупроводниковых структур
- 17:45–18:00 **Резник Р.Р.**, Котляр К.П., Гридчин В.О., Илькив И.В., Radhakrishnan R., Akopian N., Baretin D., Цырлин Г.Э.
Подходы к улучшению свойств массива квантовых точек в нитевидных нанокристаллах

Полупроводниковые лазеры**Зал ФТИ • 16:30–18:00**

- 16:30–17:00 **Пихтин Н.А.**, Слипченко С.О.
Мощные диодные лазеры диапазона длин волн 800–2000 нм для различных применений
- 17:00–17:15 **Гавриленко В.И.**
Двухфотонные квантовые каскадные лазеры терагерцового диапазона
- 17:15–17:30 **Хабибуллин Р.А.**, Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Павлов А.Ю., Галиев Р.Р., Пономарев Д.С., Кузьменков А.Г., Малеев Н.А., Васильев А.П., Зубов Ф.И., Максимов М.В., Белов Д.А., Иконников А.В., Анфертьев В.А., Жукавин Р.Х., Гавриленко В.И.
Непрерывный квантово-каскадный лазер терагерцового диапазона с $T_{max} = 90$ K
- 17:30–17:45 **Дубинов А.А.**, Афоненко А.А., Ушаков Д.В., Хабибуллин Р.А., Гавриленко В.И.
Возможность закрытия «терагерцовой дыры» квантово-каскадных лазеров
- 17:45–18:00 **Дюделев В.В.**, Черотченко Е.Д., Врубель И.И., Михайлов Д.А., Чистяков Д.В., Мыльников В.Ю., Лосев С.Н., Когновицкая Е.А., Лютецкий А.В., Слипченко С.О., Гладышев А.Г., Подгаецкий К.А., Бабичев А.В., Папылев Д.С., Андреев А.Ю., Яроцкая И.В., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Новиков И.И., Кучинский В.И., Карачинский Л.Я., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю., Соколовский Г.С.
Мощные квантово-каскадные лазеры спектрального диапазона 8 мкм

Стендовая сессия – I**18:00–19:30****Секция 1. Объемные полупроводники: электрические и оптические свойства, релаксация носителей заряда, сверхбыстрые явления, экситоны, фононы, фазовые переходы, упорядочение твердых растворов.**

- Пн-1.1с Гасанов Э.Р., **Халилова Ш.Г.**, Мустафаева Р.К.
Колебания тока в двухдолинных полупроводниках в зависимости от ориентации внешнего электрического и магнитного полей
- Пн-1.2с **Бутылкин В.С.**, Крафтмахер Г.А., Фишер П.С.
Экситонный вклад в диэлектрическую проницаемость фотооблучаемых полупроводников: от микроволн до оптики
- Пн-1.3с **Филанович А.Н.**, Лукоянов А.В., Повзнер А.А.
Электронная структура и упругие свойства удвоенных полу-Гейслеровых сплавов $MgXY_2Z_2$ ($X=Zr/Hf$, $Y=Pd/Pt$, $Z=Bi/Sb$)
- Пн-1.4с **Бадалова З.И.**, Джахангирли З.А., Ализаде Э.Г., Абдуллаев Н.А.
Оптическая проводимость и оптические характеристики магнитных полупроводников $TlFeS_2$ и $TlFeSe_2$
- Пн-1.5с **Мамедова И.А.**, Джахангирли З.А., Ализаде Э.Г., Гасанова Р.А., Мамедов Т.Г., Абдуллаев Н.А.
Диэлектрические свойства и оптическая проводимость полупроводниковых кристаллов $ZnIn_2Se_4$
- Пн-1.6с **Жевстовских И.В.**, Аверкиев Н.С., Сарычев М.Н., Семенова О.И., Терещенко О.Е.
Энергия связи экситона и природа желтой эмиссии в спектрах фотолюминесценции в монокристаллах перовскита $CH_3NH_3PbBr_3$

Пн-1.7с	Андреев Б.А. , Кудрявцев К.Е., Красильникова Л.В., Лобанов Д.Н., Калинин М.А., Новиков А.В., Красильник З.Ф. <i>Влияние локализации носителей на спонтанную и стимулированную эмиссию InN</i>
Пн-1.8с	Лобанов Д.Н. , Калинин М.А., Кудрявцев К.Е., Андреев Б.А., Юнин П.А., Новиков А.В., Скороходов Е.В., Красильник З.Ф. <i>Влияние условий формирования структур с InGaN слоями на пороги стимулированного излучения в ИК диапазоне</i>
Пн-1.9с	Малышкина О.В., Каплунов И.А. , Рогалин В.Е., Кропотов Г.И. <i>Влияние дислокаций на теплопроводность монокристаллов германия</i>
Пн-1.10с	Соколовский Д.Н. , Хуснуллин В.Р., Гаврилов Д.Ю., Волкова Я.Ю. <i>Влияние высокого давления на электрические свойства нанокompозита $Bi_2Te_3/C60$</i>
Пн-1.11с	Кузнецов Ю.М. , Дорохин М.В., Демина П.Б., Ерофеева И.В., Здоровейщев А.В., Трушин В.Н., Болдин М.С. <i>Синтез и термоэлектрические свойства высшего силицида марганца</i>
Пн-1.12с	Иванов М.С. , Степанов Н.П. <i>Исследование температурной зависимости электропроводности и концентрации носителей заряда монокристалла твёрдого раствора $Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te_3$</i>
Пн-1.13с	Никольская А.А. , Королев Д.С., Матюнина К.С., Белов А.И., Кудрин А.В., Трушин В.Н., Дроздов М.Н., Юнин П.А., Здоровейщев А.В., Тетельбаум Д.И. <i>Модификация свойств сверширокозонного полупроводника – β-Ga₂O₃ методом ионной имплантации</i>
Пн-1.14с	Ситников М.Н. , Харьков А.М. <i>Пирозлектрический ток в селениде марганца, замещенного тулием</i>
Пн-1.15с	Бассараб В.В. , Шалыгин В.А., Шахмин А.А., Соколов В.С., Кропотов Г.И. <i>Взаимодействие излучения оптического и радиочастотного диапазонов с электронами в оксиде индия–олова</i>
Пн-1.16с	Гудовских А.С. , Уваров А.В., Баранов А.И., Вячеславова Е.А., Максимова А.А., Яковлев Г.Е., Кириленко Д.А. <i>Исследование свойств границ раздела между микрокристаллическими слоями GaP и InP, выращенными методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения на кремнии</i>
Пн-1.17с	Семенова Л.Е. <i>Процессы резонансного рассеяния света при двухфотонном возбуждении в кристалле CdS</i>
Пн-1.18с	Бочаров С.Н. , Бураков Б.Е., Орехова К.Н., Загорянская М.В., Дементьев П.А., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю., Токарев М.В. <i>Самосветящийся алмаз, активированный C14. Синтез и характеристика</i>
Пн-1.19с	Даутов А.М. , Лендяшова В.В., Котляр К.П., Сибирёв Н.В. <i>Формирование разориентированных микроструктур фторида алюминия</i>
Пн-1.20с	Абилов Ч.И. , Гасанова М.Ш., Садыгова С.Г., Касумова Э.К., Гусейнова Н.Т. <i>Особенности некоторых теплофизических свойств полупроводниковых твердых растворов $(CoSb)_{1-x}(CoSn_2)_x$</i>
Пн-1.21с	Рожков С.А. , Бакин В.В., Русецкий В.С., Голяшов В.А., Миронов А.В., Кустов Д.А., Демин А.Ю., Шайблер Г.Э., Альперович В.Л., Терещенко О.Е. <i>Тонкая структура энергетических распределений горячих электронов, эмитированных из Na_2KSb/Cs_xSb фотоанода</i>
Пн-1.22с	Каган М.С. , Папроцкий С.К., Хвальковский Н.А., Алтухов И.В., Родионов Н.Б., Большаков А.П., Ральченко В.Г., Хмельницкий Р.А., Гавриленко Л.В. <i>Транспортные явления в слабо легированном монокристаллическом алмазе</i>
Пн-1.23с	Варыгин Г.В. , Базлов Н.В., Вывенко О.Ф., Шапенков С.В., Николаев В.И. <i>Электрические свойства к-фазы Ga₂O₃</i>
Пн-1.24с	Хахулин С.А. , Фирсов Д.Д., Комков О.С. <i>Определение оптической анизотропии полупроводниковых ван-дер-ваальсовых кристаллов методами модуляционной ИК фурье-спектроскопии отражения</i>

- Пн-1.25с Николаев С.Н., Екимов Е.А., Усманов И.И., Зазымкина Д.А., Чернопицкий М.А.,
Кривобок В.С.
Люминесценция Tm^{3+} центра в кристаллах SnS_2 , выращенных при высоком давлении
- Пн-1.26с **Рагоза М.Д.**, Козырев Н.В., Некрасов С.В., Намозов Б.Р., Ракицкий М.А., Аверкиев Н.С.,
Кусраев Ю.Г.
Магнетосопротивление оптически ориентированных электронов в n-GaAs
- Пн-1.27с Забродский А.Г., Вейнгер А.И., Поклонский Н.А., **Семенихин П.В.**
Влияние эффекта кулоновской блокады на электронные и спиновые свойства компенсированного Ge:As(Ga) в области фазового перехода изолятор металл
- Пн-1.28с **Луценко Е.В.**
Молекулярно-пучковая эпитаксия, электрические и оптические свойства сильно легированных слоев $n^{++}GaN:Si$ с концентрацией электронов до $5.5 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$

Секция 8. Атомарно-тонкие полупроводники: графеноподобные наноматериалы, ван-дер-ваальсовы монослои и гетероструктуры. Перовскиты, органические полупроводники, молекулярные системы. Квантовые материалы.

- Пн-8.1с **Лозовой К.А.**, Дирко В.В., Куkenov О., Коханенко А.П.
Двумерные фазы кремния и германия на высокоориентированном пиролитическом графите
- Пн-8.2с **Черненко А.В.**, Бричкин А.С., Голышков Г.М.
Прямые и не прямые трионы в гетероструктурах с монослоями дихалькогенидов переходных металлов в вертикальном электрическом поле
- Пн-8.3с **Сёмкин В.А.**, Шабанов А.В., Мыльников Д.А., Кащенко М.А., Домарацкий И.К.,
Свинцов Д.А.
Геометрический дизайн контактов к двумерным материалам для эффективного фотодетектирования в несмещённом режиме
- Пн-8.4с **Бисти В.Е.**, Бричкин А.С., Голышков Г.М., Черненко А.В.
Люминесценция монослоев $MoSe_2$: влияние температуры и накачки
- Пн-8.5с Смирнов М.Б., **Замолоцких С.С.**
Структура и электронное строение катиона формамидиния, бромиды формамидиния и перовскитного кристалла $FAPbBr_3$
- Пн-8.6с **Шубин Н.М.**, Журавлев М.Н., Емельянов А.В., Успенский Ю.А. и Горбачев А.А.
Новый механизм асимметрии вольт-амперной характеристики симметричного молекулярного проводника с различными якорными группами
- Пн-8.7с **Васильев Ю.Б.**
Эффект краевого легирования в графене и приборы на его основе
- Пн-8.8с **Милёхин И.А.**, Родякина Е.Е., Чиглинцев Э.О., Чернов А.И., Милёхин А.Г., Латышев А.В.
Нанодиагностика колебательных свойств моно- и мультислоев MoS_2 в режиме целевого плазмона
- Пн-8.9с **Грибачев А.**, Свинцов Д., Вьюрков В.
Электросопротивление двухслойного графена, ограниченное электрон-дырочным рассеянием
- Пн-8.10с **Голышков Г.М.**, Бричкин А.С., Черненко А. В., Бисти В.Е.
Возбуждённые состояния экситонов в монослоях $MoSe_2$ и WSe_2 в спектрах отражения
- Пн-8.11с **Германенко А.В.**, Румянцев Е.Л.
Неэрмитов след в решении задачи о движении носителей в графене в скрещенных полях
- Пн-8.12с **Елисеев И.А.**, Рахлин М.В., Галимов А.И., Веретенников А.И., Котова Л.В., Китаев Ю.Э.,
Осоченко Г.В., Гасникова К.А., Алексеев П.А.
Особенности фотолюминесценции слоев гексагонального $\alpha-In_2Se_3$ нанометровой толщины
- Пн-8.13с **Каменская Т.А.**, Скориков М.Л., Пугачев М.В., Кунцевич А.Ю.
Фотолюминесценция с временным разрешением в дихалькогенидах переходных металлов
- Пн-8.14с Гайдученко И.А., Прудкогляд В.А., **Кунцевич А.Ю.**
Влияние контактов на транспортные характеристики одиночных металлических углеродных нанотрубок

- Пн-8.15с **Лобанова Е.Ю.**, Грассер Т., Дворцова П.А., Илларионов Ю.Ю., Канафиева Е.К., Коровин А.М., Кузин Д.С., Мамаев И.М., Сутурин С.М., Соколов Н.С.
Синтез и характеристика кристаллической структуры и электрофизических свойств тонких пленок WS_2 и WSe_2
- Пн-8.16с **Титова Е.И.**, Кащенко М.А., Сёмкин В.А., Домарацкий И.К., Мыльников Д.А., Свинцов Д.А.
Двухслойный графен для детектирования длинноволнового излучения

Секция 10. Полупроводниковые приборы и устройства, сенсоры: технология, методы исследования, наноприборы, архитектура транзисторов.

- Пн-10.1с **Казаков С.А.**, Гревцев М.А., Арефьева О.А., Джагацпанян И.Э.
Универсальный измеритель концентраций летучих углеводородов на основе полупроводниковых сенсоров
- Пн-10.2с **Матвеев Б.А.**, Карандашев С.А., Левинштейн М.Е., Ременный М.А., Dyakonova N.
Низкочастотные шумы в ИК свето- и фотодиодах на основе гетероструктур $p\text{-InAsAsP}/n\text{-InAs}$
- Пн-10.3с **Глазов А.Л.**, Муратиков К.Л., Капралов А.А., Козлов В.А.
Тепловой транспорт через соединения многослойных полупроводниковых структур
- Пн-10.4с **Шутаев В.А.**, Сидоров В.Г., Гребенщикова Е.А., **Яковлев Ю.П.**
Водородный генератор тока на основе диода Шоттки Pd/InP
- Пн-10.5с **Алексанян Л.А.**, Поляков А.Я., Ли И.-Х., Черных А.В., Скориков М.Л., Якимов Е.Б., Щемеров И.В., Васильев А.А.
Влияние различных методов обработок боковых стенок на характеристики глубоких центров в микро- и наносветодиодах
- Пн-10.6с **Шайблер Г.Э.**, Бакин В.В., Михеев С.С., Рожков С.А.
Вклад «фотонного переноса» в транспорт электронов в $p\text{-GaAs}$ фотокатоде
- Пн-10.7с Рожков С.А., Бакин В.В., Русецкий В.С., Кустов Д.А., Голяшов В.А., Шайблер Г.Э., **Альперович В.Л.**, Терещенко О.Е.
Механизмы эмиссии из мультищелочных $Na_2KSb(Cs,Sb)$ и полупроводниковых $GaAs(Cs,O)$ фотокатодов
- Пн-10.8с **Морозов С.В.**, Кудрявцев К.Е., Румянцев В.В., Алешкин В.Я., Янцер А.А., Жолудев М.С., Дубинов А.А., Михайлов Н.Н., Фадеев М.А., Гавриленко В.И.
Беспороговая и пороговая оже-рекомбинации в лазерных гетероструктурах с КЯ $HgTe/CdHgTe$
- Пн-10.9с **Емельянов В.М.**, Левина С.А., Нахимович М.В., Солуянов А.А. и Шварц М.З.
Гибридные фотоэлектрические модули на основе короткофокусных линз Френеля с комбинированным профилем
- Пн-10.10с **Быковский К.С.**, Захаров П.С., Скворцов Е.Б., Константинов В.С.
Верификация метода оценки времени хранения логических состояний энергонезависимой памяти FeRAM на основе кусочной аппроксимации деградационных зависимостей
- Пн-10.11с **Сидоров В.В.**, Петров П.В.
Исследование влияния ловушек носителей заряда на линейность и шум ПЗС-фотоприемника
- Пн-10.12с **Бер Б.Я.**, Казанцев Д.Ю., Мамутин В.В., Токарев М.В.
Характеризация низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур динамической вторично-ионной масс-спектрометрией
- Пн-10.13с Рожков А.В., Кайбышев В.Х., Иванов М.С., Торопов А.А., **Родин П.Б.**
Суперлюминесценция субнаносекундных арсенид-галлиевых обострительных диодов
- Пн-10.14с **Иванов В.С.**, Гец Д.С.
Подавление фотодегradации широкозонного галогенидного перовскита со смешанным анионом
- Пн-10.15с **Костромин Н.А.**, Барыкин Д.А., Дашков А. С., Горай Л.И.
Моделирование электронных свойств квантово-каскадных структур
- Пн-10.16с **Стрельчук А.М.**, Иванцов В.А., Суховеев В., Калядин А.Е.
Особенности краевой инжекционной электролюминесценции GaN рп структур

- Пн-10.17с **Махов И.С.**, Караборчев А.А., Фоминых Н.А., Комаров С.Д., Шандыба Н.А., Черненко Н.Е., Салий Ю.А., Солодовник М.С., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е.
Управление излучением микродисковых лазеров с InAs/InGaAs квантовыми точками с помощью пространственно-неоднородного возбуждения
- Пн-10.18с **Бакаров А.К.**, Суханов М.А., Ярошевич А.С., Лошкарев И.Д., Гуляев Д.В., Журавлев К.С.
Фотоприемные сверхрешетки InAs/GaSb
- Пн-10.19с **Самарцев И.В.**, Байдусь Н.В., Балясников Д.М., Зубков С.Ю.
Метаморфные фотодиоды на длину волны 1550 нм, выращенные на подложке GaAs
- Пн-10.20с **Белов Д.А.**, Иконников А.В., Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Павлов А.Ю., Галиев Р.Р., Кузьменков А.Г., Малеев Н.А., Васильев А.П., Зубов Ф.И., Максимов М.В., Хохлов Д.Р., Хабибуллин Р.А.
Перестройка частоты непрерывных микродисковых терагерцовых квантово-каскадных лазеров
- Пн-10.21с **Жидяев К.С.**, Чигинева А.Б., Байдусь Н.В., Самарцев И.В.
Генерация оптических импульсов наносекундного диапазона в InGaAs/GaAs/AlGaAs гетеролазерах с помощью низковольтного GaAs-тиристора
- Пн-10.22с Черотченко Е.Д., Врубель И.И., **Михайлов Д.А.**, Мыльников В.Ю. Абдулразак С.Х., Дюделев В.В., Соколовский Г.С.
Температурная зависимость времени нарастания интенсивности ККЛ, излучающего в диапазоне длин волн 8 мкм
- Пн-10.23с **Романчук А.К.**, Малевская А.В., Малевский Д.А., Лебедева Н.М., Нахимович М.В., Шварц М.З.
Формирование металлических контактов и диэлектрических просветляющих покрытий для каскадных фотоэлектрических преобразователей концентрированного солнечного излучения
- Пн-10.24с **Залялов Т.М.**, Воронковский В.А., Герасимова А.К., Исламов Д.Р.
Оптимизация переключения мемристорных структур на основе HfOx с использованием электронно-лучевого воздействия
- Пн-10.25с **Минтаиров М.А.**, Евстропов В.В., Калюжный Н.А., Малевская А.В., Минтаиров С.А., Салий Р.А., Шварц М.З.
Высокоэффективные фотопреобразователи мощного лазерного излучения ближнего ИК диапазона
- Пн-10.26с **Козлов А.И.**, Латорцева Л.А.
Исследование шумов схем считывания и анализ эквивалентной шуму разности температур (NETD) фотоприёмников
- Пн-10.27с **Карабанов Г.Р.**, Горбацевич А.А.
Связанное состояние в континууме типа Фридриха-Винтгена в электрической мостовой схеме Уинстона
- Пн-10.28с **Крыжановская Н.В.**, Махов И.С., Комаров С.Д., Образцова А.А., Фоминых Н.А., Черненко Н.Е., Шандыба Н.А., Солодовник М.С., Жуков А.Е.
Генерация при комнатной температуре в полосковых лазерах рекордно-малой длины, сформированных ионным пучком
- Пн-10.29с **Багаев Т.А.**, Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Данилов А.И., Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Зайцев А.А., Маремьянин К.В., Морозов С.В., Гавриленко В.И., Галиев Р.Р., Павлов А.Ю., Пушкарев С.С., Пономарев Д.С., Хабибуллин Р.А.
Гетероструктуры AlGaAs/GaAs для лазеров терагерцового диапазона, выращенные методом МОС-гидридной эпитаксии
- Пн-10.30с **Климко Г.В.**, Серов Ю.В., Галимов А.И., Прасолов Н.А., Седова И.В., Сорокин С.В.
Формирование КТ InAs/GaAs низкой плотности методом МПЭ
- Пн-10.31с **Ладугин М.А.**, Гультиков Н.В., Яроцкая И.В., Андреев А.Ю., Рябоштан Ю.Л., Мармалюк А.А., Шестак Л.И., Старынин М.Ю., Панарин В.А.
Мощные лазерные линейки непрерывного режима работы на основе Al-free гетероструктур с КПД до 70%

- Пн-10.32с **Бобров М.А.**, Блохин С.А., Ковач Я.Н., Блохин А.А., Малеев Н.А., Кузьменков А.Г., Пазгалев А.С., Марчий М.Н., Васильев А.П., Устинов В.М.
Амплитудные шумы вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 89х нм гибридной конструкции
- Пн-10.33с Абаяратне И., Гохель В.Р., Симоненко Н.П., Симоненко Т.Л., Симоненко Е.П., Насибулин А.Г., **Федоров Ф.С.**
Исследование сенсорных характеристик оксида цинка, легированного цирконием, полученного методом программируемого совместного осаждения

Секция 11. Нано- и оптомеханика.

- Пн-11.1с **Шевырин А.А.**, Погосов А.Г., Бакаров А.К., Шкляев А.А.
Наномеханический резонатор как сенсор квазиодномерной плотности состояний

Секция 12. Топология. Топологические изоляторы, бесщелевые материалы.

- Пн-12.1с **Максимов А.А.**, Тартаковский И.И., Зверев В.Н., Абдуллаев Н.А., Мамедов Н.Т.
Комбинационное рассеяние света и спин-фононное взаимодействие в магнитных топологических изоляторах $MnBi_2Te_4$ и $MnSb_2Te_4$
- Пн-12.2с **Алигулиева Х.В.**, Тартаковский И.И., Максимов А.А., Абдуллаев Н.А.,
Комбинационное рассеяние света в магнитных топологических изоляторах $MnSb_2Te_4$
- Пн-12.3с **Курмачев Д.А.**, Квон З.Д., Михайлов Н.Н.
Двумерный топологический андерсоновский изолятор в режиме квазibalлистического транспорта
- Пн-12.4с **Естюнин Д.А.**, Фролов А.С.
Модификация электронной структуры топологических изоляторов $GeBi_2Te_{4-x}Se_x$ и $SnBi_2Te_{4-x}Se_x$
- Пн-12.5с Лончаков А.Т., **Бобин С.Б.**
Наблюдение квантового линейного магнитосопротивления в ультрачистом монокристалле селенида ртути
- Пн-12.6с **Бобин С.Б.**, Лончаков А.Т.
Гигантский планарный эффект Холла в халькогенидах ртути
- Пн-12.7с Тимофеев В.Е., **Барамыгина Ю.В.**, Аристов Д.Н.
Топологический переход в спектре магнонов скирмионного кристалла
- Пн-12.8с **Тимофеев В.Е.**, Аристов Д.Н.
Локализованные магнонные состояния в скирмионных кристаллах
- Пн-12.9с Микаева А.С., **Голяшов В.А.**, Кавеев А.К., Ищенко Д.В., Супрун С.П., Терещенко О.Е.
Особенности электронной структуры $Pb_{1-x}Sn_xTe$ с составами вблизи точки инверсии зон
- Пн-12.10с **Федотов Н.И.**, Зайцев-Зотов С.В.
Сканирующая туннельная спектроскопия тонких плёнок Bi_2Te_3
- Пн-12.11с Баников М.И., Пугачев М.В., Борисов А.Э., Селиванов Ю.Г., Сахин В.О., Куковицкий Е.Ф., **Кунцевич А.Ю.**
Значительное повышение подвижности носителей в 3D топологических изоляторах на основе халькогенидов висмута

Вторник, 8 октября**Полупроводниковые оптические приборы****Зал АУ • 09:15–11:00**

- 9:15–9:45 **Максимов А.А.**, Тартаковский И.И.
Вертикально излучающий компактный инжекционный полупроводниковый лазер циркулярно-поляризованного света на основе хирального $AlAs/(Al,Ga)As/GaAs$ микрорезонатора
- 9:45–10:00 **Пономарев Д.С.**, Лаврухин Д.В., Галиев Р.Р., Ячменев А.Э., Хабибуллин Р.А., Кведер В.В., Курлов В.Н., Спектор И.Е., Зайцев К.И.
Полупроводниковый источник интенсивных терагерцовых импульсов с массивом сапфировых ближнепольных микролинз

- 10:00–10:15 **Мармалюк А.А.**, Иванов А.В., Ладугин М.А., Лобинцов А.В., Сапожников С.М., Симаков В.А.
Полупроводниковые лазеры и фотоприемники на основе InP
- 10:15–10:30 **Зубов Ф.И.**, Шерняков Ю.М., Салий Ю.А., Максимов М.В.
Переключения длины волны генерации в оптически связанной паре диодных лазеров на InAs/InGaAs/GaAs квантовых точках
- 10:30–10:45 **Семенов А.Н.**, Нечаев Д.В., Алексеев П.А., Буренина Д.С., Смирнова И.П., Задиранов Ю.М., Кулагина М.М., Трошков С.И., Лихачёв А.И., Калиновский В.С., Контрош Е.В., Прудченко К.К., Нагорный А.В., Луценко Е.В., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Жмерик В.Н.
Изготовление солнечно-слепых фотодиодов Шоттки на основе AlGaN гетероструктур с высоким содержанием Al
- 10:45–11:00 **Мухин И.С.**, Неплох В.В., Кочетков Ф.М., Федоров В.В., Кавеев А.К., Новикова К.Н., Можаров А.М., Цырлин Г.Э., Исламова Р.М., Насибулин А.Г., Чернышева М.
Эластичные светоизлучающие структуры на основе массивов $A^{III}B^V$ ННК, инкапсулированных в полимерные матрицы

Фотоника и плазмоника

Зал ФТИ • 09:15–11:00

- 9:15–9:45 **Милёхин А.Г.**, Курусь Н.Н., Басалаева Л.С., Родякина Е.Е., Васильев Р.Б., Милёхин И.А., Zahn D.R.T., Латышев А.В.
Оптическая наноскопия полупроводниковых наноструктур
- 9:45–10:15 **Яблонский А.Н.**, Новиков А.В., Юрасов Д.В., Степихова М.В., Шмагин В.Б., Захаров В.Е., Перетокин А.В., Шалеев М.В., Шенгуров Д.В., Родякина Е.Е., Смагина Ж.В., Дьяков С.А., Михайлов А.Н., Тетельбаум Д.И.
Спектроскопия фото- и электролюминесценции SiGe наноструктур с двумерными фотонными кристаллами
- 10:15–10:45 **Муравьев В.М.**, Кукушкин И.В.
Плазмонные метаструктуры: от физики к приложениям
- 10:45–11:00 **Гаврилов С.С.**
Фазовые домены в неравновесных спинорных конденсатах поляритонов

Двумерные электронные системы – I

Зал АУ • 11:30–13:00

- 11:30–11:45 **Волков В.А.**
Латеральное экранирование плазмонов зарядами изображения в многозатворных 2D электронных системах
- 11:45–12:00 **Загороднев И.В.**, Родионов Д.А.
Плазмоны в латерально ограниченных анизотропных и сильно экранированных двумерных электронных системах
- 12:00–12:15 **Попов В.В.**, Полищук О.В., Машинский К.В., Фатеев Д.В.
Плазмонные моды со смешанной четностью в прямоугольной двумерной электронной системе
- 12:15–12:30 **Афанасьев А.Н.**, Алексеев П.С., Грешнов А.А., Семина М.А.
Сдвиговые бернштейновские моды в двумерной электронной жидкости
- 12:30–12:45 **Алешкин В.Я.**, Дубинов А.А.
Влияние легирования на спектр оптических фононов и электрон-фононное рассеяние в GaAs квантовых ямах
- 12:45–13:00 **Ковалёв В.М.**, Парафило А.Г., Савенко И.Г., Энтин М.В.
Магнетосопротивление смеси безмассовых и массивных фермионов в квантовом пределе

Нанопотоника

Зал ФТИ • 11:30–12:45

- 11:30–12:00 **Федянин А.А.**
Полупроводниковые метаповерхности для интегральной нанопотоники и оптических аналоговых вычислений

- 12:00–12:15 Shan H., Sun M., Höfling S., **Savenko I.G.** and Schneider C.
Временная когерентность микрорезонаторных поляритонов в 0D, 1D и 2D системах
- 12:15–12:30 **Крайнов И.В.**, Галимов А.И., Рахлин М.В., Шубина Т.В., Торопов А.А.
Генерация когерентных многофотонных состояний из одиночной квантовой точки
- 12:30–12:45 Юрасов Д.В., Степихова М.В., Перетокин А.В., Шалеев М.В., Дьяков С.А., Гиппиус Н.А., Тиходеев С.Г., Смагина Ж.В., Уткин Д.Е., **Новиков А.В.**
Управление излучением в структурах с Ge наноструктурами, встроенными в фотонные кристаллы, за счет управляемого понижения симметрии

Нульмерные полупроводниковые системы – I**Зал АУ • 14:30–16:00**

- 14:30–15:00 **Шамирзаев Т.С.**, Смирнов Д.С., Некрасов С.В., Кусраев Ю.Г., Яковлев Д.Р., Bayer M.
Экситоны в непрямозонных квантовых точках: тонкая структура состояний и спиновая динамика
- 15:00–15:15 **Семина М.А.**, Головатенко А.А., Родина А.В.
Эффект Зеемана в валентной зоне полупроводниковых нанокристаллов: кубическая анизотропия и спин-орбитальное смешивание
- 15:15–15:30 **Некрасов С.В.**, Смирнова О.О., Козырев Н.В., Рагоза М.Д., Козлов И.И., Михайленко Н.О., Родина А.В., Кусраев Ю.Г.
Динамика оптического выстраивания темных экситонов в магнитном поле в наноплателетах CdSe/CdS
- 15:30–15:45 **Смирнова О.О.**, Козырев Н.В., Некрасов С.В., Рагоза М.Д., Козлов И.И., Родина А.В., Кусраев Ю.Г.
Оптическое выстраивание и оптическая ориентация экситонов в наноплателетах CdSe/CdS при импульсном возбуждении
- 15:45–16:00 Клименко Г.А., Хасан А.А., Якимов Б.П., Саиджонов Б.М., Васильев Р.Б., Манцевич В.Н., **Смирнов А.М.**
Управление оптическими и нелинейно-оптическими свойствами двумерных градиентных нанокристаллов CdSe_{1-x}S_x

Полупроводниковая спинтроника – I**Зал ФТИ • 14:30–16:00**

- 14:30–15:00 **Аверкиев Н.С.**, Манцевич В.Н., Рожанский И.В.
Динамическая поляризация спинов носителей заряда в полупроводниках структурах пониженной размерности
- 15:00–15:15 **Манцевич В.Н.**, Смирнов Д.С.
Ориентация спина локализованного электрона в системе со спин-орбитальным взаимодействием: эффект Кондо и спиновый эффект Нернста
- 15:15–15:30 **Терещенко О.Е.**, Кустов Д.А., Голяшов В.А., Рожков С.А., Альперович В.Л., Шайблер Г.Э., Бакин В.В., Русецкий В.С.
Вакуумный спиновый светодиод
- 15:30–15:45 **Николаев Г.А.**, Хисамеева А.Р., Андреева С.А., Дрёмин А.А., Федотова Я.В., Щепетильников А.В., Кукушкин И.В.
Микроволновая спектроскопия фазового перехода двумерной сильно коррелированной электронной системы в режиме квантового эффекта Холла
- 15:45–16:00 **Кокурин И.А.**, Аверкиев Н.С.
Модель косвенного обменного взаимодействия и ферромагнетизм в GaMnAs

Нульмерные полупроводниковые системы – II**Зал АУ • 16:30–18:00**

- 16:30–16:45 **Смирнов Д.С.**, Кавокин К.В.
Охлаждение ядерных спинов сильно локализованными электронами
- 16:45–17:00 **Галимов А.И.**, Рахлин М.В., Клишко Г.В., Сорокин С.В., Седова И.В., Кулагина М.М., Задиранов Ю.М., Торопов А.А.
Стабилизация зарядового состояния одиночной квантовой точки при резонансном возбуждении

- 17:00–17:15 **Моисеев К.Д.**, Романов В.В., Пархоменко Я.А., Дементьев П.А., Иванов Э.В., Яковлев Ю.П.
Наногетероструктуры на основе узкозонных твердых растворов InAs-InSb
- 17:15–17:30 Тимофеев В.А., **Скворцов И.В.**, Машанов В.И., Никифоров А.И., Блошкин А.А., Кириенко В.В., Чуманов И.В., Коляда Д.В., Фирсов Д.Д., Комков О.С.
Структурные, оптические и электрофизические свойства многослойных периодических структур с квантовыми точками GeSiSn
- 17:30–17:45 **Минтаиров А.М.**, Аксенов В.Ю., Лебедев Д.В., Власов А.С., Blundell S.
Подавление молекулярных состояний дираковских энионов в спектрах магнито-фотолюминесценции квантовых точек InP/GaInP₂
- 17:45–18:00 **Аристов Д.Н.**, Барамыгина Ю.В., Тимофеев В.Е.
Особенности магнитной динамики скирмионных кристаллов

Объемные полупроводники – II**Зал ФТИ • 16:30–18:00**

- 16:30–17:00 **Кудрявцев К.Е.**, Лобанов Д.Н., Калинин М.А., Андреев Б.А., Новиков А.В.
Рекомбинационные процессы и оптическое усиление в лазерных структурах ближнего ИК диапазона на основе InGaN
- 17:00–17:15 **Гриджин В.О.**, Котляр К.П., Драгунова А.С., Резник Р.Р., Цырлин Г.Э.
Нитевидные нанокристаллы InGaN: рост, физические свойства и применение
- 17:15–17:30 **Денисов Д.В.**, Михайлин Н.Ю., Шамшур Д.В., Парфеньев Р.В., Зюзин А.Ю., Шаренкова Н.В.
Низкотемпературные особенности магнитных свойств сверхпроводящего полупроводникового твердого раствора (Pb_zSn_{1-z})_{1-x}In_xTe
- 17:30–17:45 **Забродский А.Г.**, Вейнгер А.И., Семенихин П.В., Абросимов Н.В., Козловский В.В.
Проявление ферромагнитных свойств Si:P в области фазового перехода изолятор-металл
- 17:45–18:00 (онлайн) **Поклонский Н.А.**, Вырко С.А., Забродский А.Г.
Расчет температуры Кюри–Вейсса для полупроводников с водородоподобными примесями на примере n-Si:P

Стендовая сессия – II (2, 4, 6, 7)**18:00–19:30**

Секция 2. Поверхность, пленки, слои: эпитаксия, атомная и электронная структура поверхности, адсорбция, процессы формирования (самоорганизации) нанокластеров, СТМ и АСМ, оптическая микроскопия ближнего поля.

- Вт-2.1с **Гришин Т.С.**, Волкова Л.С., Громов Д.Г.
Исследование формирования нанокластеров Ag и Au на поверхности SiO₂ в процессе низкотемпературного отжига
- Вт-2.2с **Волкова Л.С.**, Гришин Т.С., Громов Д.Г.
Формирование и исследование свойств массивов наностолбиков TiO_x с наночастицами Ag и Cu
- Вт-2.3с **Лебедев М.В.**, Львова Т.В., Седова И.В., Королёва А.В., Жижин Е.В., Лебедев С.В.
Поверхность Al_{0.3}Ga_{0.7}As (100): окисление на воздухе и восстановление сульфидными растворами
- Вт-2.4с Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Орлова Т.А., **Сокура Л.А.**, Соломникова А.В., Шарофидинов Ш.Ш.
Исследование эволюции морфологии полуполярных AlN (10-11) слоев, выращенных на наноструктурированной подложке Si(100)
- Вт-2.5с **Чарикова Т.Б.**, Павлова А.Ю., Поздин А.В., Корх Ю.В., Кузнецова Т.В., Воронин В.И., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н.
Транспорт носителей заряда в йодированных пленках сульфида свинца
- Вт-2.6с Спирина А.А., Манцурова С.В., **Шварц Н.Л.**
Влияние свойств и структуры поверхности подложки на морфологию планарных нанопроволок GaAs (Монте-Карло моделирование)
- Вт-2.7с **Бакулин А.В.**, Кулькова С.Е., Hocker S.
Адгезия и электронная структура интерфейса графен/Fe(110)

- Вт-2.8с **Кулькова С.Е.**, Бакулин А.В.
Влияние кислорода и фтора на электронную структуру поверхности GaSb(111)
- Вт-2.9с **Карлина Л.Б.**, Власов А.С., Левин Р.В., Малевская А.В., Сошников И.П.
Самокаталитический рост InP и GaInP наноструктур на кремнии из паровой фазы
- Вт-2.10с **Берковиц В.Л.**, Кособукин В.А., Улин В.П., Хахулин С.А.
Нанокластеры золота на поверхности GaP(001): химическое приготовление, локализованные плазмоны
- Вт-2.11с **Неустроев Е.П.**, Прокопьев А.Р.
Применение быстрого джоулевого нагрева для синтеза проводящих углеродных нанопленок
- Вт-2.12с **Исмаилов А.М.**, Умаханов М.А., Рабаданов М.Р., Рабаданов М.Х.
Получение эпитаксиальных пленок оксида цинка методом магнетронного распыления горячей керамической мишени
- Вт-2.13с **Буравлев А.Д.**, Казакин А.Н., Мохов Д.В., Нащекина Ю.А., Нащекин А.В., Убийвовк Е.В., Астраханцева В.А., Кузьмин В.А., Осипов А.В., Кукушкин С.А.
Монолитно интегрированные слои SiC с нанотрубками
- Вт-2.14с **Смирнова М.А.**, Лобзов К.Н., Бачурин В.И., Мазалецкий Л.А., Пухов Д.Э., Рудый А.С., Чурилов А.Б.
Факторы, определяющие инициирование развития периодического рельефа на поверхности кремния при ионной бомбардировке
- Вт-2.15с Ивченко В.С., Клековкин А.В., Минаев И.И., **Казанцев Д.В.**, Казанцева Е.А.
Изображения квантовых точек InSb, полученные на длине волны 10.6 мкм с помощью ASNOМ
- Вт-2.16с **Горячев А.В.**, Дудин А.А., Кириленко Е.П., Рудаков Г.А.
Исследование тонких пленок NbN методами оже электронной спектроскопии и времяпролетной ВИМС
- Вт-2.17с **Минаев И.И.**, Клековкин А.В., Ерошенко Г.Н., Свиридов Д.Е., Савин К.А., Кривобок В.С., Пашкеев Д.А., Николаев С.Н.
Использование микроскопии сопротивления растекания для исследования эпитаксиальных структур A^3B^5 содержащих Sb
- Вт-2.18с **Зубов Д.Н.**, Яковлев В.Б.
Локальная зарядка и поляризация пленок SiO₂ как инструмент создания и модификации микроструктур
- Вт-2.19с **Якушев М.В.**, Рыхлицкий С.В., Швец В.А., Спесивцев Е.В.
In-situ эллипсометрический мониторинг процессов роста гетеро-структур HgCdTe
- Вт-2.20с **Яковлев И.А.**, Лукьяненко А.В.
Исследование методом ДОБЭ начальных этапов эпитаксиального роста Mn₅Ge₃ на Si(111)
- Вт-2.21с Гуляев Д.В., Дмитриев Д.В., Милёхин И.А., **Пономарев С.А.**, Журавлев К.С.
Механизм формирования наноямок на поверхности InAlAs слоя на подложке InP
- Вт-2.22с **Шапенков С.В.**, Харитонский П.В., Тимашов Р.Б., Степанов А.И., Сергиенко Е.С., Николаев В.И.
Mist-CVD эпитаксия и магнетизм тонких слоев α -Cr₂O₃
- Вт-2.23с **Казанцев Д.М.**, Бакин В.В., Рожков С.А., Шайблер Г.Э., Альперович В.Л., Голяшов В.А., Терещенко О.Е.
Тонкая структура в распределении по энергии электронов, эмитированных из p-GaAs(Cs,O): расчет
- Вт-2.24с **Петров А.С.**, Рогило Д.И., Щеглов Д.В., Латышев А.В.
Влияние реконструкции ($\sqrt{3}\times\sqrt{3}$)-Sn на кинетику субмонослойного эпитаксиального роста на поверхности Si(111)
- Вт-2.25с **Телегин А.В.**, Лобов И.Д., Меренцова К.А., М.С. Артемьев, Носов А.П., Сухоруков Ю.П.
Вклад подложки в линейные магнитооптические эффекты в тонкопленочных диэлектрических структурах

- Вт-2.26с **Нечаев Д.В.**, Семенов А.Н., Жмерик В.Н.
Исследования процессов адсорбции/десорбции металлов при росте гетероструктур (Al,Ga)N методом плазменно-активированной МПЭ
- Вт-2.27с **Дураков Д.Е.**, Петров А.С., Роголо Д.И., Макеева А.А., Никифоров Д.Ф., Курусь Н.Н., Милёхин А.Г., Щеглов Д.В., Латышев А.В.
Влияние резистивного отжига в условиях СВВ на морфологию и структуру поверхности 6H-SiC(0001)
- Вт-2.28с **Черненко Н.Е.**, Лахина Е.А., Шаров В.А., Мельниченко И.А., Шандыба Н.А., Балакирев С.В., Крыжановская Н.В., Солодовник М.С.
Исследование особенностей процессов наноразмерной модификации подложек GaAs с различной ориентацией
- Вт-2.29с **Шарков М.Д.**, Бойко М.Е., Бутенко П.Н., Бойко А.М., Заричный А.А., Крымов В.М., Шапенков С.В., Алмаев А.В., Николаев В.И.
Блочная структура гомоэпитаксиального слоя β -Ga₂O₃/ β -Ga₂O₃ (100)
- Вт-2.30с **Умаханов М.А.**, Исмаилов А.М.
Эпитаксиальные пленки оксида галлия на подложках (0001)Al₂O₃, полученные ВЧ-магнетронным распылением
- Вт-2.31с **Солодовник М.С.**, Черненко Н.Е., Кириченко Д.В., Махов И.С., Мельниченко И.А., Шандыба Н.А., Крыжановская Н.В., Балакирев С.В.
Формирование и свойства низкоплотных квантовых точек в системе GaInAlAs на структурированных подложках GaAs(001)
- Вт-2.32с **Духан Д.Д.**, Балакирев С.В., Солодовник М.С.
Исследование влияния As- и Me-стабилизации на подвижность адатомов при капельной эпитаксии на подложках AlGaAs
- Вт-2.33с **Гордеева А.Б.**, Зубкова М.В., Левин Р.В., Маричев А.Е., Пушный Б.В.,
Оптическая диагностика гетероструктур InAs/GaSb (001)
- Вт-2.34с **Свинкин Н.А.**, Кондратьев В.М., Большаков А.Д.
Исследование адсорбции молекул NH₃ и HCl на поверхности кремния (100)
- Вт-2.35с **Колосовский Д.А.**, Залялов Т.М., Пономарев С.А., Шухов Ю.Г., Морозов А.А., Старинский С.В.
Нанывление сверхтонких пленок золота методом импульсной лазерной абляции при комнатной температуре
- Вт-2.36с **Рожков С.А.**, Бакин В.В., Шайблер Г.Э.
Новая методика определения вероятности выхода фотоэлектронов из полупроводников в вакуум
- Вт-2.37с **Левичев М.В.**, Андреева Н.В., Вилков О.Ю., Петухов А.Е.
Вклад поверхностных состояний в резистивные эффекты, наблюдаемые в тонких эпитаксиальных сегнетоэлектрических пленках титаната бария
- Вт-2.38с **Бутенко П.Н.**, Печников А.И., Бойко М.Е., Гузилова Л.И., Крымов В.М., Шапенков С.В., Шарков М.Д., Сошников И.П., Заричный А.А., Николаев В.И.
Влияние ориентации подложки на гомоэпитаксиальный рост слоев β -Ga₂O₃
- Вт-2.39с **Алексеев П.А.**, Сахно Д.Д., Дунаевский М.С.
Трибоэлектрическая генерация при трении высоколегированного алмазного зонда о поверхность кремния
- Вт-2.40с **Тихонова Е.Д.**
Оптимизация процесса травления фоторезиста для метода двойного паттернирования

Секция 4. Нульмерные системы (квантовые точки, нанокристаллы, наноплателеты): энергетический спектр, оптические свойства, туннельный транспорт.

- Вт-4.1с **Косарев А.Н.**, Черкашин Н.А., **Чалдышев В.В.**
Локализация носителей заряда в самоорганизованных квантовых точках InGaAs

- Вт-4.2с **Абрамкин Д.С.**, Касьянов Д.В., Петрушков М.О., Емельянов Е.А., Богомолов Д.Б., Есин М.Ю., Александров И.А., Мансуров В.Г., Путятю М.А., Преображенский В.В.
Гетероструктуры с A^3-B^5 квантовыми точками для устройств универсальной памяти
- Вт-4.3с **Свит К.А.**, Гуляев Д. В., Журавлев К.С.
Люминесцентные свойства нанокристаллов $Cd_xZn_{1-x}S$, синтезированных в матрице Ленгмюра-Блоджетт
- Вт-4.4с **Кузнецова М.С.**, Батаев М.Н., Колобкова Е.В., Петров М.Ю., Игнатъев И.В.
Двухфотонное поглощение света в перовскитных нанокристаллах в стеклянной матрице
- Вт-4.5с **Байдусь Н.В.**, Балясников Д.М., Дёмина П.Б., Дорохин М.В., Здравейщев А.В., Зубков С.Ю., Ерофеева И.В., Кузнецов Ю.М.
Термоэлектрическая эффективность пленок $GaAs/InGaAs$ с квантовыми точками и ям-точками
- Вт-4.6с **Басалаева Л.С.**, Емельянов Е.А., Фёдоров В.В., Дворецкая Л.Н., Преображенский В.В., Милёхин А.Г.
Оптическая спектроскопия эпитаксиальных нанокристаллов $GaAs$ с нанометровым пространственным разрешением
- Вт-4.7с **Батаев М.Н.**, Панькин Д.В., Смирнов М.Б., Кузнецова М.С., Игнатъев И.В., Елисеев И.А., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Колобкова Е.В.
Фононные повторения в спектрах фотолюминесценции перовскитных нанокристаллов $CsPbI_3$
- Вт-4.8с **Фролов Д.А.**, Манцевич В.Н., Маслова Н.С., Рожанский И.В., Аверкиев Н.С.
Спин-поляризованный электронный транспорт в коррелированных полупроводниковых наноструктурах
- Вт-4.9с **Бабкина А.Н.**, Харисова Р.Д., Зырянова К.С., Кузьменко Н.К., Никоноров Н.В.
Фазовые переходы нанокристаллов перовскитов $CsPb(Br_xI_{1-x})_3$, выделенных в матрице борогерманатного стекла
- Вт-4.10с **Истомин И.Е.**, Чекулаев М.С., Бабкина Л.А., Ильина В.В., Mahi Singh, Ястребов С.Г.
О механизме усиления флуоресценции квантовых точек на основе фрагментов графена люминесценцией поверхностного поляритона нанокластеров ZnO
- Вт-4.11с **Истомин И.Е.**, Чекулаев М.С., Ястребов С.Г.
Флуоресценция квантовых точек на основе фрагментов графена в лабораторных и межзвездных разновидностях аморфных аллотропных модификациях углерода
- Вт-4.12с Бодунов Е.Н., **Simões Gamboa A.L.**
Неэкспоненциальная кинетика затухания люминесценции нанокристаллов и ее долговременное поведение
- Вт-4.13с Сотничук М.К., **Иконников А.В.**, Хохлов Д.Р., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Гавриленко В.И.
Особенности спектров остаточной фотопроводимости в гетероструктурах на основе $CdHgTe$
- Вт-4.14с **Simões Gamboa A.L.**, Бодунов Е.Н., Федоров А.В.
Квантово-размерный эффект в полупроводниковом полом шаре
- Вт-4.15с **Балакирев С.В.**, Кириченко Д.В., Черненко Н.Е., Шандыба Н.А., Махов И.С., Надточий А.М., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е., Солодовник М.С.
Влияние соотношения потоков As/Ga при заращивании квантовых точек $InAs/GaAs$ на их оптические свойства
- Вт-4.16с **Кочерешко В.П.**, Котова Л.В., Шамирзаев Т.С.
Зеемановское расщепление экситона в объеме, квантовых ямах и квантовых точках
- Вт-4.17с **Шапенков С.В.**, Вывенко О.Ф., Убийвовк Е.В.
Расширенные дислокационные узлы как квантовые точки в GaN
- Вт-4.18с **Бурдов В.А.**, Фомичёв С.А.
Скорости и пороговые энергии процесса однофотонного рождения биэкситонов в нанокристаллах

- Вт-4.19с **Лендяшова В.В.**, Илькив И.В., Талалаев В.Г., Шугабаев Т., Резник Р.Р., Цырлин Г.Э.
Оптические свойства гетероструктур с квантовыми точками InAs в кремнии
- Вт-4.20с **Штром И.В.**, Сибирев Н.В., Илькив И.В., Убийвовк Е.В., Сошников И.П., Резник Р.Р., Микушев С.В., Цырлин Г.Э.
Рост GaAs нитевидных нанокристаллов с амфотерным катализатором
- Вт-4.21с **Цапанова Л.Г.**, Рагоза М.Д., Некрасов С.В., Михайленко Н.О., Кусраев Ю.Г.
Оптическое выстраивание и ориентация экситонов в наклонном магнитном поле в непрямозонных квантовых точках (In,Al)As/AlAs
- Секция 6. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры): примеси с мелкими и глубокими уровнями, магнитные примеси, структурные дефекты, неупорядоченные полупроводники, одиночные примеси и центры окраски.**
- Вт-6.1с **Калентьева И.Л.**, Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Дудин Ю.А., Нежданов А.В., Здоровейщев А.В., Парафин А.Е.
Использование ионной имплантации и комбинированного отжига для изготовления ферромагнитного полупроводника GaMnAs
- Вт-6.2с **Васильев А.А.**, Кочкова А.И., Поляков А.Я., Романов А.А., Матрос Н.Р., Алексанян Л.А., Щемеров И.В. и Пиртон С.Дж.
Определение температурной зависимости сечения захвата на глубокие уровни в β -Ga₂O₃
- Вт-6.3с **Офицерова Н.Ю.**, Сарычев М.Н., Жевстовских И.В., Суриков В.Т., Аверкиев Н.С., Гудков В.В.
Проявление эффекта Яна-Теллера в кристаллах селенида цинка, легированных ионами переходных металлов
- Вт-6.4с **Кахраманов С.Ш.**, Абдуллаев Н.А., Оруджова Х.В., Абдуллаев Ю.А., Гасанова Р.А.
Свойства теллурида висмута, легированного бором
- Вт-6.5с Калинушкин В.П., Уваров О.В., Гладилин А.А., **Миронов С.А.**, Гаврищук Е.М., Савин Д.В., Иконников В.Б.
Примесно-дефектные центры и их пространственное распределение в кристаллах ZnSe, легированных железом с помощью высокотемпературной диффузии
- Вт-6.6с **Александров И.А.**, Журавлев К.С.
Миграционные барьеры диффузии атомов As и P в InP и InAs для вакансионного и непрямого междоузельного механизмов диффузии
- Вт-6.7с **Давыдов В.Ю.**, Смирнов А.Н., Елисеев И.А., Лебедев А.А., Левинштейн М.Е., Козловский В.В.
Оптические и электрофизические исследования диодов Шоттки, облученных протонами и электронами
- Вт-6.8с **Ружевич М.С.**, Дорогов М.В., Смирнов А.М., Мынбаев К.Д., Баженов Н.Л., Варавин В.С., Ремесник В.Г., Ужаков И.Н., Михайлов Н.Н.
Термический отжиг HgCdTe с большим содержанием CdTe
- Вт-6.9с **Ружевич М.С.**, Романов В.В., Мынбаев К.Д., Баженов Н.Л., Томкович М.В., Моисеев К.Д.
Оптические и электрические характеристики гетероструктур InAsSb/InAsSbP II типа
- Вт-6.10с **Козловский В.В.**, Лебедев А.А., Малевский Д.А., Сахаров А.В., Левинштейн М.Е., Николаев А.Е., Кузьмин Р.А.
Радиационная стойкость нитрида галлия по отношению к протонному и электронному облучению
- Вт-6.11с **Денисенко Д.С.**, Колесников Н.Н.
Распределение ионов переходных металлов в некоторых кристаллах A^{IV}B^{VI} выращенных из расплава
- Вт-6.12с **Соломникова А.В.**, Зубков В.И.
Особенности определения примесного состава в эпитаксиальных слоях монокристаллического алмаза

- Вт-6.13с Мажукина К.А., **Румянцев В.В.**, Иконников А.В., Михайлов Н.Н., Варавин В.С., Чилиясов А.В., Жолудев М.С., Гавриленко В.И., Морозов С.В.
Исследования спектров терагерцовой фотопроводимости и фотолюминесценции твердых растворов HgCdTe, легированных мышьяком
- Вт-6.14с **Осинных И.В.**, Малин Т.В., Милахин Д.С., Журавлёв К.С.
Фотолюминесцентные свойства слоев GaN-on-Si и GaN-on-SiC, выращенных методом аммиачной МЛЭ
- Вт-6.15с **Антонов В.А.**, Калугин А.П., Володин В.А., Попов В.П., Мяконьких А.В., Руденко К.В., Скуратов В.А., О'Коннелл Ж.
Дефекты в кремнии-на-сапфире с прослойкой HfO₂:Al₂O₃ после облучения быстрыми ионами Хе и Вi
- Вт-6.16с **Арапкина Л.В.**, Чиж К.В., Сторожевых М.С., Уваров О.В., Дубков В.П., Воронов В.В., Поляков М.В., Волкова Л.С., Едельбекова П.А., Клименко А.А., Дудин А.А., Юрьев В.А.
Комбинационное рассеяние в поликристаллических пленках Si
- Вт-6.17с **Павлов А.В.**, Можаров А.М., Фёдоров В.В., Дворецкая Л.Н., Мухин И.С.
Анализ оптоэлектронных свойств твердых растворов AIII BV методами теории функционала плотности
- Вт-6.18с **Баранов А.И.**, Уваров А.В., Вячеславова Е.А., Максимова А.А., Гудовских А.С.
Исследование гетеропереходов типа a-Si:H/c-Si на черном кремнии емкостными методами
- Вт-6.19с Конюх Д.А., Райков И.О., **Бельтюков Я.М.**
Структура квазилокальных колебаний и неаффинных деформаций в аморфном кремнии
- Секция 7. Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон).**
- Вт-7.1с **Ормонт М.А.**, Валенко Н.В., Ляшенко А.А.
Особенности поведения высокочастотной проводимости неупорядоченных полупроводников в переходной области частот с ростом температуры
- Вт-7.2с Шахмин А.А., Герасимова В.В., Мусихин С.Ф., **Кропотов Г.И.**
Взаимодействие терагерцового излучения с монокристаллическим германием
- Вт-7.3с **Петров А.Г.**, Андрианов А.В., Захарьин А.О.
Проявление квантовых эффектов в свойствах поверхностных плазмонов в каплях ЭДЖ в кремнии
- Вт-7.4с Ковалёв В.М., **Боев М.В.**, Кибис О.В.
Элементарные возбуждения в гибридной системе фермионов и бозонов, индуцированной высокочастотным электромагнитным полем в двумерной полупроводниковой структуре
- Вт-7.5с **Рожков А.В.**, Иванов М.С., Родин П.Б.
Мощные СВЧ колебания в лавинных арсенид-галлиевых диодах
- Вт-7.6с **Иванов М.С.**, Рожков А.В., Родин П.Б.
Ионизирующие биполярные домены Ганна как механизм субнаносекундного переключения высоковольтных GaAs диодов
- Вт-7.7с Баграев Н.Т., Клячкин Л.Е., Кукушкин С.А., Малярченко А.М., Осипов А.В., Романов В.В., Руль Н.И., **Таранец К.Б.**
Андреевские генераторы терагерцевого излучения.
- Вт-7.8с **Паршина Л.С.**, Николаева И.Н., Конникова М.Р., Солянкин П.М., Шанин М.С., Гусев Д.С., Поляков А.С., Воронин Р.И., Черобыло Е.А., Новодворский О.А., Шкуринов А.П.
Модуляция терагерцового излучения в тонких плёнках MoS₂ различных толщин под воздействием фемтосекундного лазерного излучения
- Вт-7.9с **Морозов М.Ю.**, Машинский К.В., Попов В.В.
Усиление и лазерная генерация терагерцового излучения в металлическом желобе с активным графеном в двухрезонансном режиме
- Вт-7.10с **Моисеенко И.М.**, Фатеев Д.В., Попов В.В.
Преобразование поляризации и усиление ТГц излучения в графене с электронным дрейфом

Вт-7.11с **Трухин В.Н.**, Малевич В.Л., Калиновский В.С., Мустафин И.А., Контрош Е.В., Fan X., Прудченко К.К.
О механизмах ТГц генерации в гетероструктурном p-i-n диоде $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$

Среда, 9 октября

Полупроводниковые приборы

Зал АУ • 09:00–10:45

- 9:00–9:30 **Теруков Е.И.**
 Высокоэффективные гетероструктурные солнечные элементы на кремнии
- 9:30–9:45 **Шварц М.З.**, Андреев В.М., Калюжный Н.А., Левина С.А.
Фотоэлектрические преобразователи солнечного и лазерного излучения на гетероструктурах A^3B^5
- 9:45–10:00 **Сорокин С.В.**, Климко Г.В., Седова И.В., Галимов А.И., Серов Ю.В., Веретенников А.И., Кириленко Д.А., Прасолов Н.Д., Торопов А.А.
Молекулярно-пучковая эпитаксия метаморфных гетероструктур с квантовыми точками $InAs/InGaAs$ для создания источников одиночных фотонов телекоммуникационного диапазона 1.55 мкм
- 10:00–10:15 **Ковач Я.Н.**, Блохин С.А., Бобров М.А., Блохин А.А., Малеев Н.А., Бабичев А.В., Новиков И.И., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Колодезный Е.С., Воропаев К.О., Егоров А.Ю., Устинов В.М.
Исследование α -фактора длинноволновых вертикально-излучающих лазеров на основе квантовых ям $InGaAs/InAlGaAs$
- 10:15–10:45 **Еремин В.К.**, Вербицкая Е.М.
Мегаприборы кремниевой микроэлектроники

Двумерные полупроводниковые системы – II

Зал ФТИ • 09:00–10:45

- 9:00–9:30 **Соловьев В.В.**, Кайсин Б.Д., Кукушкин И.В.
Гетероструктуры $AlGaIn/GaN$: фундаментальные оптические свойства и польза для приложений
- 9:30–9:45 **Жмерик В.Н.**, Нечаев Д.В., Семенов А.Н., Европейцев Е.А., Шубина Т.В., Яговкина М.А., Алексеев П.А., Сахно Д., Кулагина М.М., Березина Д.С., Колесникова Д.М., Задиранов Ю.М., Трошков С.И., Елисеев И.А., Давыдов В.Ю., Кириленко Д.А., Козловский В.И., Зверев М.М., Гамов Н.А., Ванг Т., Ванг Х., Аббас А.С., Торопов А.А.
Гибридные 2D/3D гетероструктуры с монослойными квантовыми ямами GaN/AlN для ультрафиолетовой оптоэлектроники
- 9:45–10:00 **Котова Л.В.**, Кочерешко В.П.
Проявление анизотропии интерфейса в квантовых ямах $CdTe$
- 10:00–10:15 Гуняга А.А., Дурнев М.В., **Тарасенко С.А.**
Фототоки, индуцированные структурированным светом
- 10:15–10:30 **Гуняга А.А.**, Дурнев М.В., Тарасенко С.А.
Генерация второй гармоники за счёт пространственной структуры излучения
- 10:30–10:45 **Авдеев И.Д.**, Нестоклон М.О.
Долинные и спиновые расщепления в нанопроволоках из халькогенидов свинца

Топологические изоляторы

Зал АУ • 11:15–13:00

- 11:15–11:45 **Степина Н.П.**, Баженов А.О., Кириенко В.В., Ищенко Д.В., Голяшов В.А., Жданов Е.С., Терещенко О.Е., Шумилин А.С., Кунцевич А.Ю.
Трехмерные тонкопленочные топологические изоляторы $(Bi, Sb)_2(Te, Se)_3$: формирование, электронные, структурные и транспортные свойства

- 11:45–12:00 **Еремеев С.В.**, Климовских И.И., Естюнин Д.А., Фильнов С.О., Шимада К., Голяшов В.А., Терещенко О.Е., Кох К.А., Фролов А.С., Сергеев А.И., Столяров В.С., Микшич Тронтль В., Петачча Л., Ди Санто Г., Талларида М., Дай Дж., Бланко-Каноса С., Валла Т., Шикин А.М., Чулков Е. В.
Взаимодействующие квантовые спин-холловский и аномально-холловский изоляторы: бислои Bi на $MnBi_2Te_4$
- 12:00–12:15 Крайнов И.В., Ниязов Р.А., Аристов Д.Н., **Качоровский В.Ю.**
Сильный немагнитный механизм рассеяния назад в краевых состояниях 2D топологического изолятора
- 12:15–12:30 **Брагинский Л.С.**, Энтин М.В.
Теория перколяционной фотопроводимости двумерного топологического изолятора критической толщины
- 12:30–12:45 **Квон З.Д.**, Ольшанецкий Е.Б., Савченко М.А., Михайлов Н.Н.
Двумерный газ дираковских электронов с высокой концентрацией в квантовых ямах на основе $HgTe$
- 12:45–13:00 **Ниязов Р.А.**, Крайнов И.В., Аристов Д.Н., Качоровский В.Ю.
Дробовой шум в интерферометрах на основе краевых геликоидальных состояний

Полупроводниковая спинтроника – II**Зал ФТИ • 11:15–13:00**

- 11:15–11:45 **Кусраев Ю.Г.**
Спиновые явления в полупроводниковых квантовых точках
- 11:45–12:00 **Новиков А.В.**, Демидов Е.В., Шалеев М.В., Юрасов Д.В., Дроздов М.Н., Ревин Л.С., Панкратов А.Л., Антонов А.В., Красильникова Л.В., Шмырин Д.А., Красильник З.Ф., Буланов А.Д., Трошин О.Ю., Ежевский А.А., Ситников С.В., Щеглов Д.В.
Изотопнообогащенные $Si/SiGe$ гетероструктуры для квантовых вычислений
- 12:00–12:15 **Серов Ю.М.**, Галимов А.И., Смирнов Д.С., Рахлин М.В., Шубина Т.В., Торопов А.А.
Определение тензора g -фактора дырки в одиночных $InAs/GaAs$ квантовых точках на основе корреляционных измерений с поляризационным разрешением
- 12:15–12:30 **Меляков С.Р.**, Жуков Е.А., Белых В.В., Колобкова Е.В., Кузнецова М.С., Яковлев Д.Р.
Когерентная спиновая динамика в нанокристаллах $CsPbBr_3$ в стеклянной матрице
- 12:30–13:00 **Кавокин К.В.**, Литвяк В.М., Чербунин Р.В., Бажин П., Грибакин Б.Ф., Калевич В.К.
Спиновая термодинамика ядер в полупроводниковых структурах

Четверг, 10 октября**Нанопотоника – II****Зал АУ • 09:15–11:00**

- 9:15–9:45 **Кулаковский В.Д.**
Хиральные метаповерхности для управления направлением и поляризацией излучения из волноводов и микрорезонаторов
- 9:45–10:15 **Тиходеев С.Г.**
О порогах лазерной генерации и мультисtabilitéности в хиральных полупроводниковых микрорезонаторах
- 10:15–10:30 **Деменев А.А.**, Фрадкин И.М., Ковальчук А.В., Кулаковский В.Д., Антонов В.Н., Дьяков С.А. и Гиппиус Н.А.
Плазмонная решётка на планарном волноводе для связи поляризованных волноводных мод и циркулярного света
- 10:30–10:45 **Вяткин Е.С.**, Пошакинский А.В., Тарасенко С.А.
Возникновение спинового и орбитального углового момента света в закрученных фотонных структурах

10:45–11:00 **Алексеев П.А.**, Милёхин И.А., Елисеев И.А., Гасникова К.А., Бородин Б.Р., Кравцов В.А., Михин А.О., Давыдов В.Ю., Милёхин А.Г.
Управление экситонной фотолюминесценцией в дисковых резонаторах на основе гетероструктур дихалькогенидов переходных металлов

Экстремально-двумерные полупроводники**Зал ФТИ • 09:15–11:00**

9:15–9:45 **Глазов М.М.**
Транспорт экситонов в ван-дер-ваальсовых гетероструктурах

9:45–10:00 Коковин А.Д., Качоровский В.Ю., **Бурмистров И.С.**
Затухание изгибных фононов в двумерных изгибных материалах

10:00–10:15 **Дурнев М.В.**, Смирнов Д.С.
Долинное смешивание интерфейсных экситонов на латеральных гетеропереходах

10:15–10:30 **Рахлин М.В.**, Сорокин С.В., Галимов А.И., Елисеев И.А., Давыдов В.Ю., Кириленко Д.А., Торопов А.А., Шубина Т.В.
Аллотропные наноструктуры $Ga_2Se_3/GaSe$, выращенные методом ван-дер-ваальсовой эпитаксии: узкие экситонные линии и однофотонное излучение

10:30–10:45 **Еналдиев В.В.**
Управление сегнетоэлектрическими доменами в релаксированных сверхрешетках муара

10:45–11:00 **Шубина Т.В.**, Галимов А.И., Рахлин М.В., Елисеев И.А., Казанов Д.Р., Пошакинский А.В.
Экситоны и экситон-поляритоны в напряженных наноструктурах на основе дихалькогенидов переходных металлов

Поверхностные процессы в полупроводниках**Зал АУ • 11:30–13:00**

11:30–11:45 **Зиновьева А.Ф.**, Зиновьев В.А., Кацюба А.В., Володин В.А., Двуреченский А.В.
Рост силицена методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках $CaF_2/Si(111)$, модифицированных электронным облучением

11:45–12:00 **Кавеев А.К.**, Алексеев Е. А., Кириленко Д.А., Крыжановская Н.В., Маленин А.П., Минив Д.В., Федоров В.В., Мухин И.С.
Температурно-зависимая модификация морфологии висмута при эпитаксиальном росте на $CaF_2/Si(111)$

12:00–12:15 **Петров А.С.**, Рогило Д.И., Щеглов Д.В., Латышев А.В.
Атомные процессы на поверхности $Si(111)$ при адсорбции Sn

12:15–12:30 **Захожев К.Е.**, Пономарев С.А., Рогило Д.И., Голяшов В.А., Курусь Н.Н., Гутаковский А.К., Кох К.А., Щеглов Д.В., Милёхин А.Г., Латышев А.В.
Ван-дер-ваальсовый гетероэпитаксиальный рост $SnSe_2$ на поверхностях $Bi_2Se_3(0001)$ и $Si(111)$

12:30–12:45 **Рогило Д.И.**, Пономарев С.А., Насимов Д.А., Кох К.А., Рябищенкова А.Г., Голяшов В.А., Щеглов Д.В., Латышев А.В.
Процессы на поверхности $Bi_2Se_3(0001)$ при адсорбции In

12:45–13:00 **Пономарев С.А.**, Рогило Д.И., Голяшов В.А., Курусь Н.Н., Миронов А.Ю., Милёхин А.Г., Щеглов Д.В., Латышев А.В.
Гистерезис низкотемпературного фазового перехода $\beta \leftrightarrow \beta'$ в пленках In_2Se_3

Двумерные полупроводники**Зал ФТИ • 11:30–13:00**

11:30–11:45 **Яковлев З.А.**, Глазов М.М.
Тонкая структура энергетического спектра тетранов Сурица в двумерных полупроводниках

11:45–12:15 **Шкуринов А.П.**
Твердотельные источники терагерцового излучения на основе фазово-изменяемых материалов и молекулярно-кристаллических сред

12:15–12:30 **Свинцов Д.А.**, Моисеенко И.М., Капралов К.Н., Бандурин Д.А., Monch E., Ганичев С.Д.
О связи ширины циклотронного резонанса и времен релаксации гармонических деформаций ферми-сферы

- 12:30–12:45 **Ткаченко В.А.**, Ярошевич А.С., Квон З.Д., Кузьмин Н.С., Ткаченко О.А., Бакшеев Д.Г., Марчишин И.В., Бакаров А.К., Родякина Е.Е., Антонов В.А., Попов В.П., Латышев А.В.
Высокая чувствительность наносистем к СВЧ из-за емкостных связей в окружении образца
- 12:45–13:00 **Андреев И.В.**, Муравьев В.М., Кукушкин И.В.
Эффект Парселла для плазмонов в двумерной системе с задним затвором

Примеси и дефекты – I**Зал АУ • 14:30–16:00**

- 14:30–15:00 **Кривобок В.С.**, Клоков А.Ю., Ченцов С.И., Усманов И.И., Шарков А.И., Николаев С.Н.
Использование in-situ измерений низкотемпературной микрофотолуминесценции для наблюдения перестройки примесно-дефектной системы кубических полупроводников под воздействием лазерного гиперзвука
- 15:00–15:15 **Говоркова Т.Е.**, Окулов В.И., Ваулин А.А., Гавико В.С., Суриков В.Т.
Высокотемпературный ферромагнетизм нового типа в разбавленных магнитных полупроводниках: роль гибридизации примесных электронных состояний
- 15:15–15:30 **Гудков В.В.**, Сарычев М.Н., Жевстовских И.В., Офицера Н.Ю., Коростелин В.Ю., Аверкиев Н.С.
Квантовая акустика полупроводников, легированных ионами переходных металлов
- 15:30–15:45 **Лебедев А.А.**, Козловский В.В., Левинштейн М.Е., Стрельчук А.М., Давыдовская К.С., Кузьмин Р.А.
Исследование процессов радиационного дефектообразования в карбиде кремния
- 15:45–16:00 **Кукушкин С.А., Осипов А.В.**
Оптические, электрические и магнитные свойства карбида кремния с кремниевыми вакансиями, выращенного из кремния методом согласованного замещения атомов

Двумерные электронные системы – II**Зал ФТИ • 14:30–16:00**

- 14:30–15:00 **Шашкин А.А.**
Переход металл-изолятор в параллельном магнитном поле и эффекты межэлектронного взаимодействия в двумерной электронной системе
- 15:00–15:15 **Погосов А.Г.**, Сарыпов Д.И., Похабов Д.А., Жданов Е.Ю., Шевырин А.А., Бакаров А.К., Шкляев А.А.
Температурная зависимость вязкости электронов в сверхбаллистических GaAs точечных контактах
- 15:15–15:30 **Похабов Д.А.**, Егоров Д.А., Погосов А.Г., Жданов Е.Ю., Сарыпов Д.И., Шевырин А.А., Бакаров А.К.
Усиление e-e взаимодействия в подвешенном ДЭГ
- 15:30–15:45 **Будкин Г.В.**, Ивченко Е.Л.
Влияние кулоновского взаимодействия на линейный фотогальванический эффект в полупроводниках
- 15:45–16:00 **Калевич В.К.**, Кавокин К.В., Афанасьев М.М., Грибакин Б.Ф., Кусраев Ю.Г.
Эффект Керра, индуцированный обменным взаимодействием электронов, разделенных потенциальным барьером в двойных квантовых ямах

Примеси и дефекты – II**Зал АУ • 16:30–17:30**

- 16:30–16:45 **Яковлева В.В.**, Лихачев К.В., Музафарова М.В., Бабунц Р.А., Баранов П.Г., Титков С.В.
Сканирующая NV-спектроскопия как инструмент для диагностики алмазов и их скрытокристаллических структур
- 16:45–17:00 **Учаев М.В.**, Лихачев К.В., Вейшторт И.П., Баранов П.Г.
Спектроскопия сверхтонкого взаимодействия методом антипересечения спиновых уровней для реализации полностью оптической векторной магнитометрии на основе 4H-SiC
- 17:00–17:15 **Соболев Н.А.**, Калядин А.Е., Аруев П.Н., Забродский В.В., Шек Е.И., Штельмах К.Ф.
Люминесценция протяженных дефектов в кремнии

17:15–17:30 **Козлов Д.В.**, Румянцев В.В., Янцер А.А., Мажукина К.А., Жолудев М.С., Морозов С.В., Гавриленко В.И.
Рекомбинация Шокли – Рида – Холла в узкозонных слоях HgCdTe через состояния вакансий ртути

Поверхность, пленки, слои, наноструктуры – II

Зал ФТИ • 16:30–17:30

16:30–16:45 **Михайлов Н.Н.**, Варавин В.С., Дворецкий С.А., Меньшиков Р.В., Ремесник В.Г., Ужаков И.Н., Швеиц В.А., Морозов С.В.
Низкоразмерные структуры на основе HgCdTe для физических исследований и приборных применений

16:45–17:00 Ивченко В.С., Иевлева В.А., **Казанцев Д.В.**, Кунцевич А.Ю.
Возбуждение бегущих фонон-поляритонных волн резонансной электромагнитной волной в присутствии брегговской металлической маски на поверхности SiC

17:00–17:15 **Клоков А.Ю.**, Фролов Н.Ю., Шарков А.И., Пугачёв М.В., Кунцевич А.Ю.
Нормальное и латеральное ван-дер-ваальсово взаимодействие слоев в гетероструктурах Al/hBN/MoS₂/ и Al/WSe₂/ плавленый кварц

17:15–17:30 Ступак М.Ф., **Дворецкий С.А.**, Михайлов Н.Н., Макаров С.Н., Елесин А.Г.
Исследование и измерение напряжений в ртутьсодержащих гетероструктурах на основе HgCdTe

Стендовая сессия – III (3, 5, 9)

17:30–19:00

Секция 3. Двумерные и одномерные системы, гетероструктуры, сверхрешетки: структурные, электронные, магнитные и оптические свойства, электронный транспорт, туннелирование, локализация, плазмоны, квантовый эффект Холла, корреляционные эффекты.

Чт-3.1с **Черемисин М.В.**
Модель низкотемпературного транспорта в двумерных системах и коррекция критерия кристаллизации Вигнера

Чт-3.2с **Черемисин М.В.**
Темновой плазмон в частично экранированном двумерном газе в геометрии диска

Чт-3.3с **Войцеховский А.В.**, Дзядох С.М., Горн Д.И., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Сидоров Г.Ю., Якушев М.В., Средин В.Г.
Исследование токовых и адмиттансных характеристик nB(SL)n-структур на основе HgCdTe

Чт-3.4с **Неверов В.Н.**, Гудина С.В., С.Д. Попов, Туруткин К.В., Васильевский И.С., Виниченко А.Н.
Разность потенциалов неэквивалентных контактов в отсутствие тока через образец в режиме квантового эффекта Холла

Чт-3.5с **Куркина И.И.**, Винокуров П.В., Давыденко А.В., Черноусов Н.Н., Турпак А.А., Алексеев А.А.
Перпендикулярная магнитная анизотропия в магнитных структурах, включающих слои MoS₂

Чт-3.6с **Кочкова А.И.**, Поляков А.Я., Якимов Е.Б., Саранин Д.С., Черных А.В., Васильев А.А., Гостищев П.А., Алексанян Л.А., Матрос Н.Р., Щемеров И.В., Пиртон С.Дж.
Глубокие центры в гетеропереходе NiO/β-Ga₂O₃: сравнение с диодом Шоттки

Чт-3.7с **Якунин М.В.**, Алешкин В.Я., Неверов В.Н., Попов М.Р., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А.
Двойная квантовая яма p-HgTe/CdHgTe в параллельном магнитном поле

Чт-3.8с **Жолудев М.С.**, Литовченко О.М., Морозов С.В.
Туннельные гетероструктуры для лазеров и приёмников на основе HgCdTe

Чт-3.9с **Заболотных А.А.**, Рубан В.П.
Плазменные солитоны в экранированной двумерной электронной системе

Чт-3.10с **Сандаков Н.С.**, Гудина С.В., Неверов В.Н., Боголюбский А.С., Туруткин К.В., Якунин М.В., Васильевский И.С., Виниченко А.Н.
Магнитотранспортные явления в метаморфных гетероструктурах с квантовой ямой InGaAs

Чт-3.11с **Белова Д.Д.**, Котова Л.В., Гуревич А.С., Кочерешко В.П.
Интерфейсные состояния в структурах с квантовыми ямами ZnSe/BeTe в сильном магнитном поле

- Чт-3.12с **Никонов А.В.**, Заболотных А.А., Волков В.А.
Плазменные колебания в двумерных электронных системах с массивом электродов
- Чт-3.13с **Горай Л.И.**, Пирогов Е.В., Соболев М.С., Дашков А.С., Борисов М.М., Якунин С.Н., Юнин П.А., Буравлев А.Д.
Сверхпериодические модуляции в сверхмногопериодных сверхрешетках GaAs/AlGaAs, выращиваемых методом молекулярно-пучковой эпитаксии
- Чт-3.14с Ерошенко Г.Н., Кривобок В.С., Ченцов С.И., Минаев И.И., Клековкин А.В., Савин К.А., Гончаров А.Е., Муратов А.В., **Дубовая А.Р.**, Свиридов Д.Е., Николаев С.Н.
Структурные и оптические свойства T2SL InAs/GaSb с компенсацией упругих напряжений, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии
- Чт-3.15с **Дубовая А.Р.**, Кривобок В.С., Ерошенко Г.Н., Минаев И.И., Клековкин А.В., Савин К.А., Гончаров А.Е., Муратов А.В., Николаев С.Н.
Температурная зависимость структуры минизон короткопериодной сверхрешетки InAs/GaSb
- Чт-3.16с **Тараненко А.В.**, Басалаева Л.С., Федоров В.В., Тумашев В.С., Милёхин А.Г.
Оптические фононы нанопроволок GaP со встроенной каплей Ga
- Чт-3.17с **Саитов Ш.Р.**, Снигирев Г.О., Смирнов А.М., Манцевич В.Н.
Электрические и фотоэлектрические свойства пленок нанопластинок CdSe
- Чт-3.18с Янцер А.А., Румянцев В.В., Окомельков А.В., **Фадеев М.А.**, Уточкин В.В., Разова А.А., Мажукина К.А., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Варавин В.С., Гавриленко В.И., Морозов С.В.
Фото- и электролюминесценция в гетероструктурах с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe в среднем ИК диапазоне
- Чт-3.19с **Захарченко М.В.**, Глинский Г.Ф.
Анализ оптического отклика полупроводниковых гетероструктур на основе квантовых ям методами квантовой теории поля
- Чт-3.20с **Сарыпов Д.И.**, Похабов Д.А., Погосов А.Г., Жданов Е.Ю., Шевырин А.А., Бакаров А.К.
Особенности квантования кондактанса многоканальных квантовых точечных контактов
- Чт-3.21с Жилицкий В.Е., Антонов В.А., **Попов В.П.**, Мяконьких А.В., Руденко К.В.
Импеданс-спектроскопия high-k UTBB SOI структур с высокоомными TR-HR слоями для СВЧ ИС
- Чт-3.22с **Егоров Д.А.**, Похабов Д.А., Погосов А.Г., Жданов Е.Ю., Сарыпов Д.И., Шевырин А.А., Бакаров А.К.
Роль рассеяния на малые углы в подавлении нелокального сопротивления в методе магнитной фокусировки
- Чт-3.23с **Шандыба Н.А.**, Еременко М.М., Шаров В.А., Махов И.С., Черненко Н.Е., Кириченко Д.В., Балакирев С.В., Крыжановская Н.В., Солодовник М.С.
Селективное формирование высокоплотных массивов вертикальных ННК GaAs с помощью локальной ФИП-обработки подложек Si(111)
- Чт-3.24с Кривобок В.С., Пашкеев Д.А., Клековкин А.В., **Минаев И.И.**, Савин К.А., Ерошенко Г.Н., Гончаров А.Е., Николаев С.Н.
Структурные и оптические свойства твердых растворов $InAs_{1-x}Sb_x$ для средневолновых и длинноволновых инфракрасных фотодетекторов
- Чт-3.25с **Калинников М.А.**, Лобанов Д.Н., Андреев Б.А., Кудрявцев К.Е., Юнин П.А., Скороходов Е.В., Новиков А.В., Красильник З.Ф.
Особенности формирования низкоразмерных структур на основе InN/InGaN методом ПА МПЭ
- Чт-3.26с **Семина М.А.**, Глазов М.М.
Трионы в анизотропном ван-дер-ваальсовом магнетике CrSBr
- Чт-3.27с **Брагинский Л.С.**, Энтин М.В.
Теория температурных поправок к кондактансу подвешенной квантовой проволоки
- Чт-3.28с **Барышников К.А.**, Герт А.В., Васильев Ю.Б., Дмитриев А.П.
Нелинейное экранирование зарядов в периодически легированном графене

- Чт-3.29с **Родионов Д.А.**, Загороднев И.В.
Уникальное поведение магнитодисперсии фундаментального краевого магнитоплазмона в сильно экранированном прямоугольном двумерном электронном газе
- Чт-3.30с **Понкратова Д.В.**, Загороднев И.В.
Интерфейсные электронные состояния на стыке цепочек атомов
- Чт-3.31с **Талыфлы А.Ф.**, Алигулиева Х.В., Мамедзаде Н.Ф., Сулейманов М.Н.
Экспериментальное исследование колебательных свойств In_2Se_3
- Чт-3.32с **Махмудиан Мехрдад М.**, Махмудиан М.М., Энтин М.В.
Теория вигнеровской жидкости в подзатворном диэлектрике флеш-памяти
- Чт-3.33с **Махмудиан М.М.**, Энтин М.В.
Теория сил Казимира между двумя квантовыми пленками
- Чт-3.34с **Ткаченко О.А.**, Ткаченко В.А., Бакшеев Д.Г., Сушков О.Р.
Магнитный пробой в сверхрешетках с одномерной и двумерной модуляцией: расчеты в подходе Ландауэра-Бьюттикера
- Чт-3.35с **Маслов А.Ю.**, Прошина О.В.
Поляронная масса носителей в планарных структурах, содержащих слои с различной степенью ионности
- Чт-3.36с **Философов Н.Г.**, Агекян В.Ф., Вербин С.Ю., Резницкий А.Н., Серов А.Ю., Штром И.В., Илькив И.В., Резник Р.Р., Цырлин Г.Э.
Перенос возбуждения через широкий барьер в системе квантовых ям GaAs/AlGaAs различной ширины
- Чт-3.37с **Орехова К.Н.**, Дементьев П.А., Жмерик В.Н., Заморянская М.В.
Ловушки в многослойных структурах на основе AlGaIn
- Чт-3.38с **Тюменцев М.М.**, Федотов Н.И., Мартовицкий В.П., Зайцев-Зотов С.В.
Влияние растяжения на фазовый переход в TaS₂
- Чт-3.39с **Гудина С.В.**, Арапов Ю.Г., Неверов В.Н., Савельев А.П., Шелушинина Н.Г., Якунин М.В.
Электрон-электронное взаимодействие в структурах InGaAs/GaAs
- Чт-3.40с **Сибирев Н.В.**, Илькив И.В., Убийвовк Е.В., Штром И.В., Сошников И.П., Резник Р.Р., Брюханова В.В., Цырлин Г.Э.
Рост GaAs нитевидных нанокристаллов с богатой Si каплей на вершине
- Чт-3.41с **Адамов Р.Б.**, Мелентьев Г.А., Подоскин А.А., Слипченко С.О., Седова И.В., Сорокин С.В., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А.
Люминесценция наноструктур с легированными квантовыми ямами при оптической и электрической накачке
- Чт-3.42с **Чжэн Шимин**, Храмцов Е.С., Игнатьев И.В.
Моделирование влияние электрического поля на экситонные состояния в квантовой яме
- Чт-3.43с **Фадеев М.А.**, Янцер А.А., Разова А.А., Уточкин В.В., Кудрявцев К.Е., Румянцев В.В., Дубинов А.А., Алешкин В.Я., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В.
Генерация излучения при температуре 290 К в гетероструктуре с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe на длине волны 3.55 мкм за счёт улучшения волновода и активной области
- Чт-3.44с **Ершов А.В.**, Юшков Д.А., Байдусь Н.В., Белов А.И., Здравейщев А.В., Крюков Р.Н.
Свойства многослойных наноструктур «субоксид кремния/олово», подвергнутых быстрому и статическому отжигу
- Чт-3.45с **Котова Л.В.**, Рахлин М.В., Галимов А.И., Шубина Т.В., Кочерешко В.П.
Оптические свойства ван-дер-ваальсовых структур на основе WS₂
- Чт-3.46с Михайлова М.П., Иванов Э.В., Парфеньев Р.В., Калинина К.В., **Семенихин П.В.**
Особенности осцилляций магнитосопротивления в композитных квантовых ямах InAs/GaSb с инвертированным зонным спектром в квантующем магнитном поле
- Чт-3.47с **Воропаев Д.М.**, Прудкогляд В.А., Жувагин И.В., Звягин И., Морочо А.А., Григорьев П.Д., Тюменцев М.М., Кон И.А., Зайцев-Зотов С.В., Pachoud E., Hadj-Azzem A., Monceau P.
Осцилляции проводимости Шубникова — де Гааза в квазидвумерном проводнике с волнами зарядовой плотности $HoTe_3$

Секция 5. Спин-зависимые явления, спинтроника, наномagnetизм, квантовые технологии.

- Чт-5.1с **Хомицкий Д.В.**, Бастракова М.В., Пашин Д.С.
Влияние диссипации и релаксации на динамику в модели спин-зарядового кубита в двойной квантовой точке
- Чт-5.2с **Повзнер А.А.**, Волков А.Г., Зайцева Н.А., Ноговицына Т.А., Лопатко Э.И.
Переход металл-полупроводник в $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ во внешних электрических полях
- Чт-5.3с **Аплеснин С.С.**, Харьков А.М., Ситников М.Н.
Магнитосопротивление на постоянном и переменном токе в селениде марганца, замещенного тулием с переменной валентностью
- Чт-5.4с **Здоровейцев А.В.**, Дорохин М.В., Кудрин А.В., Темирязева М.П., Темирязов А.Г.
Пленки вида ферромагнетик/тяжелый металл как функциональные слои полупроводниковых приборов оптоэлектроники
- Чт-5.5с **Бажин П.С.**, Литвяк В.М., Кавокин К.В.
Моделирование спин-спиновых взаимодействий в CdTe
- Чт-5.6с **Кустов Д.А.**, Русецкий В.С., Голяшов В.А., Рожков С.А., Бакин В.В., Шайблер Г.Э., Альперович В.Л., Шамирзаев Т.С., Терещенко О.Е.
Оптическая ориентация спина электронов в термомеханически напряжённых $Na_2KSb(Cs,Sb)$ фотокатодах
- Чт-5.7с **Богословский Н.А.**, Петров П.В., Аверкиев Н.С.
Неупорядоченный антиферромагнетизм в легированных полупроводниках. Метод плотности состояний.
- Чт-5.8с **Копчинский И.Д.**, Шорохов В.В.
Моделирование электронного переноса через локализованные взаимодействующие состояния квантовых точек в формализме псевдочастичной неравновесной диаграммной техники
- Чт-5.9с **Козырев Н.В.**, Барышников К.А., Намозов Б.Р., Козлов И.И., Аверкиев Н.С., Кусраев Ю.Г.
Оптическая ориентация спинов возбуждённого состояния иона марганца в $(Zn, Mn)Se$ при резонансном фотовозбуждении
- Чт-5.10с **Кудрин А.В.**, Лесников В.П., Яковлева А.А., Крюков Р.Н., Татарский Д.А.
Магнетизм в GaAs структурах, дельта легированных Fe
- Чт-5.11с **Усачёв П.А.**, Кац В.Н., Шелухин Л.А., Аверьянов Д.В., Соколов И.С., Парфёнов О.Е., Талденков А.Н., Токмачёв А.М., Сторчак В.Г., Павлов В.В.
Магнитооптические и фотоиндуцированные явления в эпитаксиальных плёнках EuO
- Чт-5.12с **Дорохин М.В.**, Ведь М.В., Демина П.Б., Кудрин А.В., Здоровейцев А.В., Лесников В.П.
Спиновая инжекция в гетероструктурах $A^3B^5:Fe/GaAs$
- Чт-5.13с **Ракицкий М.А.**, Рагоза М.Д., Аверкиев Н.С., Кусраев Ю.Г.
Теория фотопроводимости в полупроводниках, обусловленной оптической ориентацией электронов
- Чт-5.14с **Головатенко А.А.**, Луцевич Д.А., Родина А.В.
Трионный механизм фарадеевского вращения в коллоидных наноплателетах CdSe
- Чт-5.15с **Андреева С.А.**, Щепетильников А.В., Хисамеева А.Р., Николаев Г.А., Кукушкин И.В.
Ферромагнитный фазовый переход на факторе заполнения $\nu = 3$ в сильно коррелированной системе с псевдоспиновой степенью свободы
- Чт-5.16с **Козлов И.И.**, Козырев Н.В., Намозов Б.Р., Кусраев Ю.Г., Седова И.В., Сорокин С.В.
Влияние разброса эффективного g-фактора на фотолюминесценцию неоднородно-уширенного ансамбля эпитаксиальных квантовых точек CdSe/(Zn, Mn)Se
- Чт-5.17с **Чербунин Р.В.**, Кудинов А.В.
Рамановская спектроскопия кластеров и одиночных ионов в квантовых ямах CdReTe

Секция 9. Фотонные кристаллы, микрорезонаторы и метаматериалы. Нанопотоника, квантовая оптика.

- Чт-9.1с **Крафтмахер Г.А.**, Бутылкин В.С., Фишер П.С.
Оптически- и магнитоуправляемые мета-диполи на СВЧ
- Чт-9.2с Ушанов В.И., Еремеев С.В., Силкин В.М., **Чалдышев В.В.**
Плазмонный резонанс в системах наночастиц Sb и Bi в AlGaAs

- Чт-9.3с **Орешко И.В.**, Золотарев В.В., Казакова А.Е., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.
Резонаторы ИК-лазеров на основе двумерных фотонных кристаллов для организации поверхностного вывода излучения
- Чт-9.4с **Смагина Ж.В.**, Зиновьев В.А., Зиновьева А.Ф., Родякина Е.Е., Кацюба А.В., Степихова М.В., Новиков А.В., Михайловский М.С., Петров М.И.
Кремниевые дисковые резонаторы с контролируемым позиционированием излучателей
- Чт-9.5с **Поленок Е.Д.**, Берт Н.А., Иванов А.А., Преображенский В.В., Путятю М.А., Семягин Б.Р., Снигирев Л.А., Ушанов В.И., Яговкина М.А., Чалдышев В.В.
Брэгговский резонанс в системе слоёв плазмонных наночастиц Bi в матрице $GaAs$
- Чт-9.6с **Киселёв К.С.**, Курусь Н.Н., Голышев В.М., Дюдеева Е.С., Милёхин А.Г., Ломзов А.А., Латышев А.В.
Комбинационное рассеяние света на молекуле аденина
- Чт-9.7с **Сапегин А.А.**, Барабаненков М.Ю.
Два режима дальнего резонансного распространения электромагнитного возбуждения вдоль линейной цепочки малых сфер
- Чт-9.8с **Лебедев Д.В.**, Соломонов Н.А, Шаров В.А., Федеров В. В., И.С. Мухин
Локальные источники оптического излучения на основе туннельного контакта, интегрированные в GaP нановолноводы
- Чт-9.9с **Миронов А.Ю.**, Насимов Д.А.
Фотогальванические эффекты в изолирующих наноструктурах на основе сверхпроводящих плёнок
- Чт-9.10с **Захаров В.Е.**, Яблонский А.Н., Новиков А.В., Юрасов Д.В., Шмагин В.Б., Шалеев М.В., Шенгуров Д.В., Родякина Е.Е., Смагина Ж.В., Дьяков С.А.
Особенности пространственного распределения излучения $Ge(Si)$ nanoостровков в двумерных фотонных кристаллах в условиях оптического и электрического возбуждения
- Чт-9.11с Честнов И.Ю., Черотченко Е.Д., **Налитов А.В.**
Неадиабатическая поляритонная конденсация в кольцевых оптических ловушках
- Чт-9.12с **Бочин А.К.**, Честнов И.Ю., Налитов А.В.
Гигантский эффективный g -фактор в присутствии спиновых бифуркаций в поляритонных конденсатах
- Чт-9.13с **Голеницкий К.Ю.**, Аверкиев Н.С.
Сингулярные и бисингулярные поверхностные поляритоны в анизотропных полупроводниках
- Чт-9.14с **Зиновьев В.А.**, Зиновьева А.Ф., Смагина Ж.В., Блошкин А.А., Кучинская П.А., Двуреченский А.В., Родякина Е.Е., Дьяков С.А., Смагин И.А., Степихова М.В., Новиков А.В.
Усиление излучения $GeSi$ квантовых точек в волноводной структуре за счёт совмещения с метаповерхностью из наночастиц Ge
- Чт-9.15с **Казанов Д.Р.**, Пошакинский А.В., Шубина Т.В.
Динамика оптических мод в нанотрубках MoS_2 : от мод шепчущей галереи до экситон-поляритонов и мод Фабри-Перо
- Чт-9.16с Степихова М.В., Смолина Е.О., **Перетокин А.В.**, Юрасов Д.В., Шалеев М.В., Шенгуров Д.В., Родякина Е.Е., Новиков А.В.
Проявления топологических дефектов в люминесцентном отклике двумерных фотонных кристаллов
- Чт-9.17с **Перетокин А.В.**, Степихова М.В., Новиков А.В., Юрасов Д.В., Дьяков С.А.
Поляризационные особенности люминесцентного отклика двумерных фотонных кристаллов с nanoостровками $Ge(Si)$
- Чт-9.18с Курдюбов А.С., **Столяров В.А.**, Ложкин М.С., Ефимов Ю.П., Елисеев С.А., Ловцюс В.А., Игнатъев И.В.
Проблемы выращивания гетероструктур для реализации поляритонных лазеров
- Чт-9.19с **Сибирев Н.В.**, Лабзовская М.Э., Новиков Б.В., Серов А.Ю., Микушев С.В., Кадинская С.А., Штром И.В., Кондратьев В.М., Большаков А.Д.
Упорядоченная генерация в разбросанных нанокристаллитах оксида цинка

- Чт-9.20с **Евтихийев В.П.**, Митрофанов М.И., Вознюк Г.В.
Сфокусированный ионный пучок как инструмент для разработки новых приборов нанофотоники
- Чт-9.21с **Комаров С.Д.**, Войнилович А.Г., Фейгин Г.А., Сахаров А.В., Николаев А.Е., Иванов К.А., Моисеев Э.И., Крыжановская Н.В., Никитина Е.В., Цацульников А.Ф., Луценко Е.В., Жуков А.Е.
Исследование оптических свойств микрорезонаторов дисковой геометрии на основе широкозонных III-N материалов
- Чт-9.22с **Салахова Н.С.**, Гиппиус Н.А.
Градиентные фотонно-кристаллические решетки для локализации света
- Чт-9.23с **Курусъ Н.Н.**, Небогатикова Н.А., Романенко А.А., Милёхин И.А., Милёхин А.Г., Антонова И.В., Родякина Е.Е., Латышев А.В.
Плазмон-усиленное комбинационное рассеяние света графеном
- Чт-9.24с **Дворецкая Л.Н.**, Можаров А.М., Комаров С.Д., Вячеславова Е.А., Моисеев Э.И., Фёдоров В.В., Мухин И.С.
Создание оптических микрорезонаторов GaPNAs на кремнии

Пятница, 11 октября

Полупроводниковые гетероструктуры

Зал АУ • 09:15–11:00

- 9:15–9:45 **Румянцев В.В.**, Мажукина К.А., Уточкин В.В., Разова А.А., Дубинов А.А., Шенгуров Д.В., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Гавриленко В.И., Морозов С.В.
Лазеры с оптической накачкой среднего ИК диапазона на гетероструктурах HgCdTe с квантовыми ямами
- 9:45–10:00 **Кудинов А.В.**, Борисов Е.В., Шимко А.А., Китаев Ю.Э., Траллеро-Гинер К., Гупалов С.В.
Оптический спектр экситонного бифонного резонанса
- 10:00–10:15 **Иванов А.А.**, Чалдышев В.В., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Лундин В.В., Цацульников А.Ф.
Влияние беспорядка на оптические свойства резонансных брэгговских структур на основе III-N
- 10:15–10:30 **Разова А.А.**, Уточкин В.В., Фадеев М.А., Мажукина К.А., Янцер А.А., Румянцев В.В., Дубинов А.А., Алешкин В.Я., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Шенгуров Д.В., Морозова Е.Е., Гусев Н.С., Морозов С.В., Гавриленко В.Я.
Лазерная генерация в гетероструктурах с квантовыми ямами Hg(Cd)Te/CdHgTe в среднем инфракрасном диапазоне
- 10:30–10:45 **Покровский В.Я.**, Зыбцев С.Г.
Полупроводник NbS₃ с волнами зарядовой плотности в свете исследований на синхротроне
- 10:45–11:00 **Фирсов Д.Д.**, Коляда Д.В., Чуманов И.В., Скворцов И.В., Уткин Д.Е., Кириенко В.В., Машанов В.И., Тимофеев В.А., Комков О.С.
ИК фурье-спектроскопия наногетероструктур на основе GeSiSn/Si для устройств фотоники

Объемные полупроводники – III

Зал ФТИ • 09:15–10:45

- 9:15–9:45 **Вершовский А.К.**, Дмитриев А.К., Дмитриев С.П., Пазгалёв А.С., Петренко М.В.
Новое поколение квантовых оптических сенсоров магнитного поля на атомных и атомоподобных спиновых структурах: устройство и применение
- 9:45–10:00 **Ивченко Е.Л.**, Голуб Л.Е., Спивак Б.З.
Теория электрической магнитокиральной анизотропии в теллуре
- 10:00–10:15 **Сёмкин В.А.**, **Шабанов А.В.**, Мыльников Д.А., Кашенко М.А., Домарацкий И.К., Жуков С.С., Свинцов Д.А.
Бессдвиговое фотодетектирование с помощью геометрического паттернирования контактов
- 10:15–10:30 **Тихомирова Г.В.**, Петросян Т.К., Волкова Я.Ю., Тебеньков А.В., Соколовский Д.Н.
Трансформация фаз углеродных материалов под действием высоких давлений

10:30–10:45 **Горлова И.Г.**, Зыбцев С.Г., Покровский В.Я., Никонов С.А., Зайцев-Зотов С.В., Титов А.Н.
*Последовательный характер логарифмической релаксации фотопроводимости
квазиодномерного слоистого полупроводника TiS_3*

Наномеханика

Зал АУ • 11:30–12:15

11:30–12:00 **Шевырин А.А.**, Погосов А.Г., Бакаров А.К., Шкляев А.А., Naik A.
Взаимодействие между модами как ключ к управлению нелинейностью в наномеханических резонаторах

12:00–12:15 **Никитин М.В.**, Покровский В.Я., Зыбцев С.Г.
Аномалии модулей упругости в вискерах квазиодномерных проводников с волной зарядовой плотности

Пленарная сессия – II

Зал АУ • 12:15–13:00

12:15–13:00 **Красников Г.Я.**
Микроэлектроника и квантовые технологии

Заккрытие

Зал АУ • 13:00–14:00